



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 5 月 2 9 日
Date of Application:

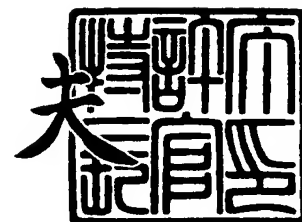
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 5 3 0 5 3
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 5 3 0 5 3]

出 願 人 ソニー株式会社
Applicant(s):

2 0 0 4 年 1 月 2 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫





【書類名】 特許願

【整理番号】 0300024503

【提出日】 平成15年 5月29日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/00

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
 内

 【氏名】 横山 誠一

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
 内

 【氏名】 花輪 幸治

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
 内

 【氏名】 芝崎 孝宜

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社
 内

 【氏名】 平野 貴之

【特許出願人】

 【識別番号】 000002185

 【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100098785

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 藤島 洋一郎

**【先の出願に基づく優先権主張】****【出願番号】** 特願2003- 85868**【出願日】** 平成15年 3月26日**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 019482**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【包括委任状番号】** 9708092**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 発光素子およびその製造方法、ならびに表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板に、下地層を介して、第 1 電極、発光層を含む層および第 2 電極が順に積層され、前記発光層で発生した光を前記第 2 電極の側から取り出す発光素子であって、

前記第 1 電極は、

前記下地層に接して設けられた密着層と、

この密着層の前記下地層とは反対側に設けられ、前記発光層で発生した光を反射させる反射層と、

この反射層の前記密着層とは反対側に設けられ、前記反射層を保護するバリア層と

を備えたことを特徴とする発光素子。

【請求項 2】 前記密着層は、クロム (Cr)、インジウム (In)、スズ (Sn)、亜鉛 (Zn)、カドミウム (Cd)、チタン (Ti)、アルミニウム (Al)、マグネシウム (Mg) およびモリブデン (Mo) からなる金属元素の群のうちの少なくとも 1 種を含む金属、導電性酸化物または金属化合物により構成されている

ことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【請求項 3】 前記反射層は、銀 (Ag) または銀を含む合金により構成された

ことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【請求項 4】 前記バリア層は、インジウム (In)、スズ (Sn)、亜鉛 (Zn)、カドミウム (Cd)、チタン (Ti)、クロム (Cr)、ガリウム (Ga) およびアルミニウム (Al) からなる金属元素の群のうちの少なくとも 1 種を含む金属、酸化物または金属化合物により構成された光透過性膜である

ことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【請求項 5】 前記バリア層は、インジウム (In) とスズ (Sn) と酸素 (O) とを含む化合物 (ITO)、インジウム (In) と亜鉛 (Zn) と酸素 (

O) とを含む化合物 (I Z O), 酸化インジウム (In_2O_3), 酸化スズ (SnO_2), 酸化亜鉛 (ZnO), 酸化カドミウム (CdO), 酸化チタン (TiO_2), 酸化クロム (CrO_2), 窒化ガリウム (GaN), 酸化ガリウム (Ga_2O_3) および酸化アルミニウム (Al_2O_3) からなる群のうちの少なくとも 1 種により構成されている

ことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【請求項 6】 前記バリア層の膜厚が、1 nm 以上 50 nm 以下である

ことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【請求項 7】 前記下地層は、平坦化層である

ことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【請求項 8】 前記発光層を含む層は、有機層である

ことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【請求項 9】 前記密着層は、前記発光層で発生し前記反射層を透過した光を反射させる反射補助膜を兼ねる

ことを特徴とする請求項 1 記載の発光素子。

【請求項 10】 前記反射補助膜は、クロム (Cr), インジウム (In), スズ (Sn), 亜鉛 (Zn), カドミウム (Cd), チタン (Ti), アルミニウム (Al), マグネシウム (Mg) およびモリブデン (Mo) からなる金属元素の群のうちの少なくとも 1 種を含む金属、導電性酸化物または金属化合物により構成されている

ことを特徴とする請求項 9 記載の発光素子。

【請求項 11】 前記反射補助膜は、50% 以上の反射率を有する

ことを特徴とする請求項 9 記載の発光素子。

【請求項 12】 基板に、下地層を介して、第 1 電極、発光層を含む層および第 2 電極が順に積層された発光素子の製造方法であって、

前記下地層の上に密着層を形成する工程と、

前記密着層の上に、前記発光層で発生した光を反射させる反射層を形成する工程と、

前記反射層の上に、前記反射層を保護するバリア層を形成する工程と、

前記バリア層、前記反射層および前記密着層を前記バリア層側から順にパターンニングすることにより前記第 1 電極を形成する工程と、
前記第 1 電極の上に、発光層を含む層を形成する工程と、
前記発光層を含む層の上に、第 2 電極を形成する工程と
を含むことを特徴とする発光素子の製造方法。

【請求項 1 3】 前記第 1 電極を形成する工程において、前記バリア層および前記反射層をパターンニングしたのち、前記密着層をパターンニングすることを特徴とする請求項 1 2 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 1 4】 前記第 1 電極を形成する工程において、前記バリア層をパターンニングしたのち、前記反射層および前記密着層をパターンニングすることを特徴とする請求項 1 2 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 1 5】 前記第 1 電極を形成する工程において、前記バリア層、前記反射層および前記密着層を、前記バリア層側から順に一層ずつパターンニングすることを特徴とする請求項 1 2 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 1 6】 前記密着層を、クロム (C r) , インジウム (I n) , スズ (S n) , 亜鉛 (Z n) , カドミウム (C d) , チタン (T i) , アルミニウム (A l) , マグネシウム (M g) およびモリブデン (M o) からなる金属元素の群のうちの少なくとも 1 種を含む金属、導電性酸化物または金属化合物により構成する

ことを特徴とする請求項 1 2 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 1 7】 前記反射層を、銀 (A g) または銀を含む合金により構成する

ことを特徴とする請求項 1 2 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 1 8】 前記バリア層は、インジウム (I n) , スズ (S n) , 亜鉛 (Z n) , カドミウム (C d) , チタン (T i) , クロム (C r) , ガリウム (G a) およびアルミニウム (A l) からなる金属元素の群のうちの少なくとも一種を含む金属、酸化物または金属化合物により構成された光透過性膜であることを特徴とする請求項 1 2 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 19】 前記バリア層を、インジウム (In) とスズ (Sn) と酸素 (O) とを含む化合物 (ITO), インジウム (In) と亜鉛 (Zn) と酸素 (O) とを含む化合物 (IZO), 酸化インジウム (In_2O_3), 酸化スズ (SnO_2), 酸化亜鉛 (ZnO), 酸化カドミウム (CdO), 酸化チタン (TiO_2), 酸化クロム (CrO_2), 窒化ガリウム (GaN), 酸化ガリウム (Ga_2O_3) および酸化アルミニウム (Al_2O_3) からなる群のうちの少なくとも 1 種により構成する

ことを特徴とする請求項 12 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 20】 前記バリア層の膜厚を、1 nm 以上 50 nm 以下とすることを特徴とする請求項 12 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 21】 前記発光層を含む層として、有機層を形成することを特徴とする請求項 12 記載の発光素子の製造方法。

【請求項 22】 基板に、下地層を介して、第 1 電極、発光層を含む層および第 2 電極が順に積層され、前記発光層で発生した光を前記第 2 電極の側から取り出す発光素子を有する表示装置であって、

前記第 1 電極は、

前記下地層に接して設けられた密着層と、

この密着層の前記下地層とは反対側に設けられ、前記発光層で発生した光を反射させる反射層と、

この反射層の前記密着層とは反対側に設けられ、前記反射層を保護するバリア層と

を備えたことを特徴とする表示装置。

【請求項 23】 前記発光層を含む層は、有機層であることを特徴とする請求項 22 記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、発光層で発生した光を第 1 電極で反射させて第 2 電極の側から取り出す発光素子およびその製造方法、ならびにこの発光素子を用いた表示装置に関

する。

【0002】

【従来の技術】

近年、フラットパネルディスプレイの一つとして、有機発光素子を用いた有機発光ディスプレイが注目されている。有機発光ディスプレイは、自発光型であるので視野角が広く、消費電力が低いという特性を有し、また、高精細度の高速ビデオ信号に対しても十分な応答性を有するものと考えられており、実用化に向けて開発が進められている。

【0003】

有機発光素子としては、例えば、基板の上に、TFT (Thin Film Transistor; 薄膜トランジスタ) および平坦化層などを介して、第1電極、発光層を含む有機層および第2電極が順に積層されたものが知られている。発光層で発生した光は、基板の側から取り出される場合もあるが、第2電極の側から取り出される場合もある。

【0004】

光を取り出す側の電極としては、インジウム (In) とスズ (Sn) と酸素 (O) とを含む化合物 (ITO; Indium Tin Oxide) などの透過性を有する導電性材料により構成された透明電極が用いられることが多い。透明電極の構成については、従来より種々の提案がなされている。例えば、ITOの厚膜化によるコスト上昇を回避するため、銀 (Ag) などよりなる金属薄膜と酸化亜鉛 (ZnO) などよりなる高屈折率薄膜とを積層するようにした提案がある (例えば、特許文献1参照。)。この透明電極では、高屈折率薄膜の厚みを5nm~350nm、金属薄膜の厚みを1nm~50nmと、高屈折率薄膜を金属薄膜に比較して相対的に厚くして透明性を高めると共に、高屈折率薄膜により金属薄膜の表面での反射を低減するようにしている。

【0005】

光を取り出さない側の電極には種々の金属電極が用いられることが多い。例えば、光を第2電極の側から取り出す場合には、陽極である第1電極は例えばクロム (Cr) などの金属により構成される。従来では、例えば、第1電極をクロム

よりなる金属材料層とクロムの酸化物よりなる緩衝薄膜層との2層構造とし、金属材料層を構成するクロムの表面粗さを緩衝薄膜層により緩和するようにした提案がある（例えば、特許文献2参照。）。

【0 0 0 6】

【特許文献1】

特開 2 0 0 2 - 3 3 4 7 9 2 号公報

【特許文献2】

特開 2 0 0 2 - 2 1 6 9 7 6 号公報

【0 0 0 7】

【発明が解決しようとする課題】

光を第2電極の側から取り出す場合、発光層で発生した光は、第2電極を通過して直接取り出されるものもあるが、第1電極で一度反射してから第2電極を通過して放出されるものもある。従来は第1電極をクロムなどにより構成していたので、第1電極における光の吸収率が大きく、第1電極で反射されてから取り出される光の損失が大きいという問題があった。第1電極の光吸収率が有機発光素子に与える影響は大きく、発光効率が低いと同一輝度を得るために必要な電流量が増加する。駆動電流量の増加は、有機発光素子の実用化にとって極めて重要な素子寿命に大きな影響を及ぼす。

【0 0 0 8】

そのため、例えば、第1電極を、金属のうちで最も反射率の高い銀（A g）または銀を含む合金により構成することが考えられる。しかしながら、一方で、銀は極めて反応性に富み、加工が難しく、かつ密着性に乏しいという性質を有している。したがって、銀の長所を発揮させ、高反射率で化学的に安定な第1電極を実現するためには、その構成および製造プロセスにおいて更に研究改良の余地がある。

【0 0 0 9】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、第1電極の剥離あるいは変質を防止して高性能を得ることができる発光素子およびその製造方法、ならびに表示装置を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明による発光素子は、基板に、下地層を介して、第1電極、発光層を含む層および第2電極が順に積層され、発光層で発生した光を第2電極の側から取り出すものであって、第1電極は、下地層に接して設けられた密着層と、この密着層の下地層とは反対側に設けられ、発光層で発生した光を反射させる反射層と、この反射層の密着層とは反対側に設けられ、反射層を保護するバリア層とを備えたものである。

【0011】

本発明による発光素子の製造方法は、基板に、下地層を介して、第1電極、発光層を含む層および第2電極が順に積層された発光素子を製造するものであって、下地層の上に密着層を形成する工程と、密着層の上に、発光層で発生した光を反射させる反射層を形成する工程と、反射層の上に、反射層を保護するバリア層を形成する工程と、バリア層、反射層および密着層をバリア層側から順にパターニングすることにより第1電極を形成する工程と、第1電極の上に、発光層を含む層を形成する工程と、発光層を含む層の上に、第2電極を形成する工程とを含むものである。

【0012】

本発明による表示装置は、基板に、下地層を介して、第1電極、発光層を含む層および第2電極が順に積層され、発光層で発生した光を第2電極の側から取り出す発光素子を有するものであって、第1電極は、下地層に接して設けられた密着層と、この密着層の下地層とは反対側に設けられ、発光層で発生した光を反射させる反射層と、この反射層の密着層とは反対側に設けられ、反射層を保護するバリア層とを備えたものである。

【0013】

本発明による発光素子および本発明による表示装置では、第1電極を、下地層に接して設けられた密着層と、発光層で発生した光を反射させる反射層と、この反射層を保護するバリア層とを有するように構成したので、バリア層により反射層の変質が防止されると共に、密着層により、反射層が下地層から剥離すること

が抑制され、剥離した部分から反射層の変質が生じるおそれなくなる。よって、反射層を銀（A g）または銀を含む合金により構成する場合に特に好適である。

【0 0 1 4】

本発明による発光素子の製造方法では、下地層の上に密着層、反射層およびバリア層が順に形成されたのち、これらのバリア層、反射層および密着層が、バリア層側から順にパターニングされることにより第1電極が形成される。続いて、第1電極の上に、発光層を含む層が形成され、その上に第2電極が形成される。

【0 0 1 5】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0 0 1 6】

〔第1の実施の形態〕

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る表示装置の断面構造を表すものである。この表示装置は、極薄型の有機発光ディスプレイとして用いられるものであり、駆動パネル10と封止パネル20とが対向配置され、熱硬化型樹脂よりなる接着層30により全面が貼り合わせられている。駆動パネル10は、例えば、ガラスなどの絶縁材料よりなる基板11の上に、T F T 1 2および平坦化層13を介して、赤色の光を発生する有機発光素子10 Rと、緑色の光を発生する有機発光素子10 Gと、青色の光を発生する有機発光素子10 Bとが、順に全体としてマトリクス状に設けられている。

【0 0 1 7】

T F T 1 2のゲート電極（図示せず）は、図示しない走査回路に接続され、ソースおよびドレイン（いずれも図示せず）は、例えば酸化シリコンあるいはP S G（Phos-Silicate Glass）などよりなる層間絶縁膜12 Aを介して設けられた配線12 Bに接続されている。配線12 Bは、層間絶縁膜12 Aに設けられた図示しない接続孔を介してT F T 1 2のソースおよびドレインに接続され、信号線として用いられる。配線12 Bは、例えばアルミニウム（A l）もしくはアルミニウム（A l）—銅（C u）合金により構成されている。なお、T F T 1 2の構

成は、特に限定されず、例えば、ボトムゲート型でもトップゲート型でもよい。

【0018】

平坦化層 13 は、TFT 12 が形成された基板 11 の表面を平坦化し、有機発光素子 10R, 10G, 10B の各層の膜厚を均一に形成するための下地層である。平坦化層 13 には、有機発光素子 10R, 10G, 10B の第 1 電極 14 と配線 12B とを接続する接続孔 13A が設けられている。平坦化層 13 は、微細な接続孔 13A が形成されるため、パターン精度が良い材料により構成されていることが好ましい。平坦化層 13 の材料としては、ポリイミド等の有機材料、あるいは酸化シリコン (SiO_2) などの無機材料を用いることができる。本実施の形態では、平坦化層 13 は、例えばポリイミド等の有機材料により構成されている。

【0019】

有機発光素子 10R, 10G, 10B は、例えば、基板 11 の側から、下地層である平坦化層 13 を介して、陽極としての第 1 電極 14、絶縁膜 15、発光層を含む有機層 16、および陰極としての第 2 電極 17 がこの順に積層されている。第 2 電極 17 の上には、必要に応じて、保護膜 18 が形成されている。

【0020】

第 1 電極 14 は、反射層としての機能も兼ねており、できるだけ高い反射率を有するようにすることが発光効率を高める上で望ましい。本実施の形態では、第 1 電極 14 は、基板 11 の側から、密着層 14A、反射層 14B およびバリア層 14C がこの順に積層された構成を有している。密着層 14A は、平坦化層 13 に接して設けられ、反射層 14B が平坦化層 13 から剥離するのを防止するものである。反射層 14B は、発光層で発生した光を反射させるものである。バリア層 14C は、反射層 14B を保護するものである。

【0021】

密着層 14A は、例えば、クロム (Cr), インジウム (In), スズ (Sn), 亜鉛 (Zn), カドミウム (Cd), チタン (Ti), アルミニウム (Al), マグネシウム (Mg) およびモリブデン (Mo) からなる金属元素の群のうちの少なくとも 1 種を含む金属、導電性酸化物または金属化合物により構成され

ていることが好ましい。これらの物質は電気伝導度が高く、配線 12B との電気的な接合を良好に行うことができるからである。本実施の形態では、密着層 14A は、例えばクロムにより構成されている。

【0022】

密着層 14A は、積層方向の膜厚（以下、単に膜厚と言う）が光を透過しない程度であることが好ましい。具体的には、密着層 14A をクロムにより構成する場合には、40nm 以上 300nm であることが好ましく、更に 50nm 以上 150nm であればより好ましい。

【0023】

反射層 14B は、例えば、銀または銀を含む合金により構成されていることが好ましい。銀は金属の中で最も反射率が高く、反射層 14B における光の吸収損失を小さくすることができるからである。なお、反射層 14B を銀により構成するようにすれば反射率を最も高くすることができるので好ましいが、銀と他の金属との合金により構成するようにすれば、化学的安定性および加工精度を高めることができると共に、密着層 14A およびバリア層 14C との密着性も向上させることができるので好ましい。銀は非常に反応性が高く、加工精度および密着性も低いなど、極めて取り扱いが難しいからである。

【0024】

反射層 14B の膜厚は、例えば 50nm 以上 300nm 以下であることが好ましい。膜厚がこの範囲内であれば、密着性が確保され、第 1 電極 14 の剥離を防止することができるからである。更に、50nm 以上 150nm 以下であればより好ましい。反射層 14B を薄くすることにより表面粗さを小さくすることができ、したがってバリア層 14C の膜厚を薄くして光の取り出し効率を上げることができるからである。また、反射層 14B を薄くすることにより、製造途中の熱工程により反射層 14B が結晶化して表面の凹凸が激しくなるのを緩和し、反射層 14B 表面の凹凸によりバリア層 14C の欠陥が増加するのを阻止することができるからである。

【0025】

バリア層 14C は、反射層 14B を構成する銀あるいは銀を含む合金が空气中

の酸素あるいは硫黄成分と反応することを防止すると共に、反射層 14 B を形成した後の製造工程においても反射層 14 B がダメージを受けることを緩和する保護膜としての機能を有している。なお、ここでいうダメージとは、具体的には、例えば後述する絶縁膜 15 の開口部 15 A を形成する際に用いられる薬液などによるものが考えられる。また、バリア層 14 C は、有機層 16 への正孔注入効率を高めるという仕事関数調整層としての機能も有しており、反射層 14 B よりも仕事関数の高い材料により構成されていることが好ましい。

【0026】

バリア層 14 C は、例えば、インジウム (In), スズ (Sn), 亜鉛 (Zn), カドミウム (Cd), チタン (Ti), クロム (Cr), ガリウム (Ga) およびアルミニウム (Al) からなる金属元素の群のうちの少なくとも一種を含む金属、酸化物または金属化合物により構成された光透過性膜であることが好ましい。具体的には、インジウム (In) とスズ (Sn) と酸素 (O) とを含む化合物 (ITO; Indium Tin Oxide), インジウム (In) と亜鉛 (Zn) と酸素 (O) とを含む化合物 (IZO; Indium Zinc Oxide), 酸化インジウム (In_2O_3), 酸化スズ (SnO_2), 酸化亜鉛 (ZnO), 酸化カドミウム (CdO), 酸化チタン (TiO_2), 酸化クロム (CrO_2), 窒化ガリウム (GaN), 酸化ガリウム (Ga_2O_3) および酸化アルミニウム (Al_2O_3) からなる群のうちの少なくとも 1 種により構成されることが好ましい。これらの光透過性無機材料は、バリア層 14 C を金属材料により構成する場合に比べて表面粗さが小さくなるように成膜可能であり、銀または銀を含む合金よりなる反射層 14 B の表面粗さを緩和し、第 1 電極 14 の表面平坦性を高めることができるからである。また、第 1 電極 14 の上に形成される有機層 16 の各層の膜厚が均一になり、有機層 16 の膜厚不足による第 1 電極 14 と第 2 電極 17 との短絡の虞がなくなると共に、特に後述の共振器構造を形成する場合には画素内色むらの発生を防いで色再現性を高めることができるので好適であるからである。更に、可視光領域における光吸収性が極めて小さく、光透過性が良好であり、発光層で発生した光がバリア層 14 C を通過する際の吸収損失を最小限に抑えることができるからである。

【0027】

バリア層 14C の膜厚は、上述した保護膜としての機能を確保するためには、例えば、1 nm 以上 50 nm 以下であることが好ましく、更に、3 nm 以上 30 nm 以下であればより好ましい。

【0028】

絶縁膜 15 は、第 1 電極 14 と第 2 電極 17 との絶縁性を確保すると共に、有機発光素子 10R, 10G, 10B における発光領域の形状を正確に所望の形状とするためのものである。絶縁膜 15 は、例えば、膜厚が 600 nm 程度であり、二酸化ケイ素 (SiO_2) あるいはポリイミドなどの絶縁材料により構成され、発光領域に対応して開口部 15A が設けられている。

【0029】

有機層 16 は、有機発光素子 10R, 10G, 10B の発光色によって構成が異なっている。図 2 は、有機発光素子 10R, 10B における有機層 16 の構成を拡大して表すものである。有機発光素子 10R, 10B の有機層 16 は、正孔輸送層 16A, 発光層 16B および電子輸送層 16C が第 1 電極 14 の側からこの順に積層された構造を有している。正孔輸送層 16A は、発光層 16B への正孔注入効率を高めるためのものである。本実施の形態では、正孔輸送層 16A が正孔注入層を兼ねている。発光層 16C は、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものであり、絶縁膜 15 の開口部 15A に対応した領域で発光するようになっている。電子輸送層 16C は、発光層 16B への電子注入効率を高めるためのものである。

【0030】

有機発光素子 10R の正孔輸送層 16A は、例えば、膜厚が 45 nm 程度であり、ビス [(N-ナフチル) -N-フェニル] ベンジジン (α -NPD) により構成されている。有機発光素子 10R の発光層 16B は、例えば、膜厚が 50 nm 程度であり、2, 5-ビス [4- [N- (4-メトキシフェニル) -N-フェニルアミノ]] スチリルベンゼン-1, 4-ジカーボニトリル (BSB) により構成されている。有機発光素子 10R の電子輸送層 16C は、例えば、膜厚が 30 nm 程度であり、8-キノリノールアルミニウム錯体 (Alq_3) により構成

されている。

【0031】

有機発光素子 10B の正孔輸送層 16A は、例えば、膜厚が 30 nm 程度であり、 α -NPD により構成されている。有機発光素子 10B の発光層 16B は、例えば、膜厚が 30 nm 程度であり、4,4-ビス(2,2-ジフェニルビニル)ビフェニル(DPVBi)により構成されている。有機発光素子 10B の電子輸送層 16C は、例えば、膜厚が 30 nm 程度であり、Alq₃ により構成されている。

【0032】

図3は、有機発光素子 10G における有機層 16 の構成を拡大して表すものである。有機発光素子 10G の有機層 16 は、正孔輸送層 16A および発光層 16B が第1電極 14 の側からこの順に積層された構造を有している。正孔輸送層 16A は、正孔注入層を兼ねており、発光層 16B は、電子輸送層を兼ねている。

【0033】

有機発光素子 10G の正孔輸送層 16A は、例えば、膜厚が 50 nm 程度であり、 α -NPD により構成されている。有機発光素子 10G の発光層 16B は、例えば、膜厚が 60 nm 程度であり、Alq₃ にクマリン6(C6; Coumarin6)を1体積%混合したものにより構成されている。

【0034】

図1、図2および図3に示した第2電極 17 は、例えば、膜厚が 10 nm 程度であり、銀(Ag)、アルミニウム(Al)、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ナトリウム(Na)などの金属または合金により構成されている。本実施の形態では、例えばマグネシウム(Mg)と銀との合金(MgAg合金)により構成されている。

【0035】

第2電極 17 は、有機発光素子 10R, 10G, 10B のすべてを覆うように形成され、有機発光素子 10R, 10G, 10B の共通電極となっている。第2電極 17 の電圧降下を抑制するため、絶縁膜 15 の上には補助電極 17A が設けられていることが好ましい。補助電極 17A は、有機発光素子 10R, 10G,

10Bの隙間を縫って設けられており、その端部は、基板11の周辺部に、有機発光素子10R, 10G, 10Bが設けられた領域を取り囲むように形成された図示しない母線となる幹状補助電極に接続されている。補助電極17Aおよび図示しない母線となる幹状補助電極は、例えば、アルミニウム (Al) あるいはクロム (Cr) のような低抵抗の導電性材料を単層あるいは積層構造としたものにより構成されている。

【0036】

第2電極17は、また、半透過性反射層としての機能を兼ねている。すなわち、この有機発光素子10R, 10G, 10Bは、第1電極14の発光層16B側の端面を第1端部P1、第2電極14の発光層16B側の端面を第2端部P2とし、有機層16を共振部として、発光層16Bで発生した光を共振させて第2端部P2の側から取り出す共振器構造を有している。このように共振器構造を有するようにすれば、発光層16Bで発生した光が多重干渉を起こし、一種の狭帯域フィルタとして作用することにより、取り出される光のスペクトルの半値幅が減少し、色純度を向上させることができるので好ましい。また、封止パネル20から入射した外光についても多重干渉により減衰させることができ、後述するカラーフィルタ22 (図1参照) との組合せにより有機発光素子10R, 10G, 10Bにおける外光の反射率を極めて小さくすることができるので好ましい。

【0037】

そのためには、共振器の第1端部P1と第2端部P2との間の光学的距離Lは数1を満たすようにし、共振器の共振波長 (取り出される光のスペクトルのピーク波長) と、取り出したい光のスペクトルのピーク波長とを一致させることが好ましい。光学的距離Lは、実際には、数1を満たす正の最小値となるように選択することが好ましい。

【0038】

【数1】

$$(2L) / \lambda + \Phi / (2\pi) = m$$

(式中、Lは第1端部P1と第2端部P2との間の光学的距離、 Φ は第1端部P1で生じる反射光の位相シフト Φ_1 と第2端部P2で生じる反射光の位相シフト

Φ_2 との和 ($\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$) (rad)、 λ は第 2 端部 P 2 の側から取り出した光のスペクトルのピーク波長、 m は L が正となる整数をそれぞれ表す。なお、数 1 において L および λ は単位が共通すればよいが、例えば (nm) を単位とする。)

【0039】

ここで、本実施の形態のように第 1 電極 14 を、密着層 14A、反射層 14B およびバリア層 14C を積層した構成とした場合には、第 1 端部 P 1 の位置は、各層の材料および膜厚により異なりうる。原則として、第 1 端部 P 1 の側における発光層 16B で発生した光の反射光 h は、図 2 および図 3 に示したように、密着層 14A と反射層 14B との界面で生じる反射光 h_1 と、反射層 14B とバリア層 14C との界面で生じる反射光 h_2 と、バリア層 14C と有機層 16 との界面で生じる反射光 h_3 との合成波であり、第 1 端部 P 1 はこの合成波に対応する仮想界面となる。ただし、本実施の形態では、反射層 14B が銀または銀を含む合金により構成されているので、反射層 14B の膜厚が十分に厚ければ、密着層 14A と反射層 14B との界面で生じる反射光 h_1 はわずかである。また、バリア層 14C が上述した材料により形成されている場合には、バリア層 14C と有機層 16 との界面で生じる反射光 h_3 もわずかであり、バリア層 14C は共振部に含まれ、第 1 端部 P 1 は反射層 14B とバリア層 14C との界面と考えることができる。

【0040】

図 1 に示した保護膜 18 は、例えば、膜厚が 500 nm 以上 10000 nm 以下であり、透明誘電体からなるパッシベーション膜である。保護膜 18 は、例えば、酸化シリコン (SiO_2)、窒化シリコン (SiN) などにより構成されている。

【0041】

封止パネル 20 は、図 1 に示したように、駆動パネル 10 の第 2 電極 17 の側に位置しており、接着層 30 と共に有機発光素子 10R、10G、10B を封止する封止用基板 21 を有している。封止用基板 21 は、有機発光素子 10R、10G、10B で発生した光に対して透明なガラスなどの材料により構成されてい

る。封止用基板 21 には、例えば、カラーフィルタ 22 が設けられており、有機発光素子 10R, 10G, 10B で発生した光を取り出すと共に、有機発光素子 10R, 10G, 10B 並びにその間の配線において反射された外光を吸収し、コントラストを改善するようになっている。

【0042】

カラーフィルタ 22 は、封止用基板 21 のどちら側の面に設けられてもよいが、駆動パネル 10 の側に設けられることが好ましい。カラーフィルタ 22 が表面に露出せず、接着層 30 により保護することができるからである。カラーフィルタ 22 は、赤色フィルタ 22R, 緑色フィルタ 22G および青色フィルタ 22B を有しており、有機発光素子 10R, 10G, 10B に対応して順に配置されている。

【0043】

赤色フィルタ 22R, 緑色フィルタ 22G および青色フィルタ 22B は、それぞれ例えば矩形形状で隙間なく形成されている。これら赤色フィルタ 22R, 緑色フィルタ 22G および青色フィルタ 22B は、顔料を混入した樹脂によりそれぞれ構成されており、顔料を選択することにより、目的とする赤, 緑あるいは青の波長域における光透過率が高く、他の波長域における光透過率が低くなるように調整されている。

【0044】

さらに、カラーフィルタ 22 における透過率の高い波長範囲と、共振器構造から取り出す光のスペクトルのピーク波長 λ とは一致している。これにより、封止パネル 20 から入射する外光のうち、取り出す光のスペクトルのピーク波長 λ に等しい波長を有するもののみがカラーフィルタ 22 を透過し、その他の波長の外光が有機発光素子 10R, 10G, 10B に侵入することが防止される。

【0045】

この表示装置は、例えば、次のようにして製造することができる。

【0046】

図 4 ないし図 13 はこの表示装置の製造方法を工程順に表すものである。まず、図 4 (A) に示したように、上述した材料よりなる基板 11 の上に、TF T1

2, 層間絶縁膜 12A および配線 12B を形成する。

【0047】

次に、図4 (B) に示したように、基板 11 の全面に、例えばスピコート法により上述した材料よりなる平坦化層 13 を形成し、露光および現像により平坦化層 13 を所定の形状にパターンニングすると共に接続孔 13A を形成する。そののち、ポリイミドをイミド化させるため、クリーンベーク炉で例えば 320℃ の温度で焼成する。

【0048】

続いて、図5 (A) に示したように、平坦化層 13 の上に、例えばスパッタ法により、例えばクロム (Cr) よりなる密着層 14A を例えば 80 nm の膜厚で形成する。

【0049】

そののち、図5 (B) に示したように、密着層 14A の上に、例えばスパッタ法により、例えば銀を含む合金よりなる反射層 14B を例えば 150 nm の膜厚で形成する。このように、平坦化層 13 の上に、密着層 14A を介して反射層 14B を形成することにより、反射層 14B が下地層としての平坦化層 13 から剥離するのを防止することができる。更に、剥離した部分からエッチング液あるいは空気などが侵入し、反射層 14B を構成する銀または銀を含む合金がそれらに含まれる酸素や硫黄成分などと反応することを防止することもできる。

【0050】

次に、図5 (C) に示したように、反射層 14B の上に、例えばスパッタ法により、例えばITOよりなるバリア層 14C を例えば 15 nm の膜厚で形成する。このように、反射層 14B の成膜後、速やかにバリア層 14C を形成することにより、反射層 14B を構成する銀または銀を含む合金が空気中の酸素または硫黄成分と反応することを防止できると共に、反射層 14B を形成した後の製造工程においても反射層 14B に対するダメージを緩和し、反射層 14B とバリア層 14C との界面を清浄に保つことができる。

【0051】

密着層 14A, 反射層 14B およびバリア層 14C を形成したのち、図6 (A

）に示したように、例えばリソグラフィ技術およびウェットエッチングにより、バリア層 14 C および反射層 14 B を選択的にエッチングし、所定の形状にパターンニングする。

【0052】

続いて、図 6 (B) に示したように、例えばリソグラフィ技術およびウェットエッチングにより、密着層 14 A をパターンニングし、第 1 電極 14 を形成する。このとき、反射層 14 B の側壁をフォトリソグストにより被覆するようにすることが好ましい。反射層 14 B の側壁がウェットエッチングの薬液に触れるおそれなくなり、反射層 14 B に対するダメージを緩和することができるからである。

【0053】

そののち、図 7 (A) に示したように、基板 11 の全面にわたり、例えば C V D (Chemical Vapor Deposition ; 化学的気相成長) 法により絶縁膜 15 を上述した膜厚で成膜し、例えばリソグラフィ技術を用いて絶縁膜 15 のうち発光領域に対応する部分を選択的に除去し開口部 15 A を形成する。

【0054】

次に、図 7 (B) に示したように、絶縁膜 15 の上に、基板 11 の全面にわたり補助電極 17 A を形成し、例えばリソグラフィ技術を用いて選択的にエッチングし、所定の形状にパターンニングする。

【0055】

続いて、図 8 に示したように、例えば蒸着法により、上述した膜厚および材料よりなる有機発光素子 10 R の正孔輸送層 16 A、有機発光素子 10 R の発光層 16 B および有機発光素子 10 R の電子輸送層 16 C を順次成膜し、有機発光素子 10 R の有機層 16 を形成する。その際、形成予定領域に対応して開口 41 A を有する金属性のマスク 41 を用い、発光領域、すなわち絶縁膜 15 の開口部 15 A に対応して成膜するようにすることが好ましい。但し、開口部 15 A にのみ高精度に蒸着することは難しいので、開口部 15 A 全体を覆い、絶縁膜 15 の縁に少しかかるようにしてもよい。

【0056】

そののち、マスク 41 をずらして、図 9 に示したように、有機発光素子 10 R

の有機層 16 と同様にして、上述した膜厚および材料よりなる有機発光素子 10 G の正孔輸送層 16 A および発光層 16 B を順次成膜し、有機発光素子 10 G の有機層 16 を形成する。続いて、マスク 41 を再びずらして、同じく図 9 に示したように、有機発光素子 10 R の有機層 16 と同様にして、上述した膜厚および材料よりなる有機発光素子 10 B の正孔輸送層 16 A、発光層 16 B および電子輸送層 16 C を順次成膜し、有機発光素子 10 B の有機層 16 を形成する。なお、図 9 には、マスク 41 の開口 41 A が有機発光素子 10 B の有機層 16 に対向している状態を表している。

【0057】

有機発光素子 10 R、10 G、10 B の有機層 16 を形成したのち、図 10 に示したように、基板 11 の全面にわたり、例えば蒸着法により、上述した膜厚および材料よりなる第 2 電極 17 を形成する。これにより、第 2 電極 17 は、既に形成されている補助電極 17 A および図示しない母線となる幹状補助電極に電気的に接続される。以上により、図 1 ないし図 3 に示した有機発光素子 10 R、10 G、10 B が形成される。

【0058】

次に、図 11 に示したように、第 2 電極 17 の上に、上述した膜厚および材料よりなる保護膜 18 を形成する。これにより、図 1 に示した駆動パネル 10 が形成される。

【0059】

また、図 12 (A) に示したように、例えば、上述した材料よりなる封止用基板 21 の上に、赤色フィルタ 22 R の材料をスピンコートなどにより塗布し、フォトリソグラフィ技術によりパターンニングして焼成することにより赤色フィルタ 22 R を形成する。続いて、図 12 (B) に示したように、赤色フィルタ 22 R と同様にして、青色フィルタ 22 B および緑色フィルタ 22 G を順次形成する。これにより、封止パネル 20 が形成される。

【0060】

封止パネル 20 および駆動パネル 10 を形成したのち、図 13 に示したように、基板 11 の有機発光素子 10 R、10 G、10 B を形成した側に、熱硬化型樹

脂よりなる接着層 30 を塗布形成する。塗布は、例えば、スリットノズル型ディスペンサーから樹脂を吐出させて行うようにしてもよく、ロールコートあるいはスクリーン印刷などにより行うようにしてもよい。次いで、図 1 に示したように、駆動パネル 10 と封止パネル 20 とを接着層 30 を介して貼り合わせる。その際、封止パネル 20 のうちカラーフィルタ 22 を形成した側の面を、駆動パネル 10 と対向させて配置することが好ましい。また、接着層 30 に気泡などが混入しないようにすることが好ましい。そののち、封止パネル 20 のカラーフィルタ 22 と駆動パネル 10 の有機発光素子 10R, 10G, 10B との相対位置を整合させてから所定温度で所定時間加熱処理を行い、接着層 30 の熱硬化性樹脂を硬化させる。以上により、図 1 ないし図 3 に示した表示装置が完成する。

【0061】

この表示装置では、例えば、第 1 電極 14 と第 2 電極 17 との間に所定の電圧が印加されると、有機層 16 の発光層 16B に電流が注入され、正孔と電子とが再結合することにより、主として発光層 16B の正孔輸送層 16A 側の界面において発光が起こる。この光は、第 1 端部 P1 と第 2 端部 P2 との間で多重反射し、第 2 電極 17 を透過して取り出される。本実施の形態では、第 1 電極 14 が密着層 14A、反射層 14B およびバリア層 14C を積層した構成とされているので、バリア層 14C により反射層 14B の変質が防止されると共に、密着層 14A により、反射層 14B が平坦化層 13 から剥離することが抑制される。

【0062】

このように、本実施の形態では、第 1 電極 14 を密着層 14A、反射層 14B およびバリア層 14C を積層した構成としたので、反射層 14B の剥離あるいは変質を防止することができ、ひいては反射層 14B の変質に起因する第 1 電極 14 と第 2 電極 17 との短絡の発生などを防止することができる。よって、反射層 14B を銀 (Ag) または銀を含む合金により構成する場合に特に好適であり、表示装置の欠陥を低減し、寿命を長くすることができる。

【0063】

また、本実施の形態では、下地層としての平坦化層 13 の上に、密着層 14A、反射層 14B およびバリア層 14C をすべて形成したのちに、バリア層 14C

側から順にパターンニングすることにより第 1 電極 1 4 を形成するようにしたので、バリア層 1 4 C により、反射層 1 4 B を構成する銀または銀を含む合金が空気中の酸素または硫黄成分と反応することを防止することができると共に、反射層 1 4 B を形成した後の製造工程においても反射層 1 4 B に対するダメージを緩和することができる。また、密着層 1 4 A により、反射層 1 4 B が下地層としての平坦化層 1 3 から剥離するのを防止することができ、剥離した部分に侵入した空気あるいは薬液などによる反射層 1 4 B への悪影響を抑制することができる。

【 0 0 6 4 】

〔第 2 の実施の形態〕

図 1 4 は本発明の第 2 の実施の形態に係る表示装置の断面構造を表すものである。この表示装置は、第 1 電極 1 4 の密着層 1 4 A の代わりに、発光層 1 6 B で発生し反射層 1 4 B を透過した光を反射させる反射補助膜を兼ねる密着層兼反射補助膜 1 4 D が設けられていることを除いては、第 1 の実施の形態で説明した表示装置と同一である。したがって、同一の構成要素には同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する。

【 0 0 6 5 】

密着層兼反射補助膜 1 4 D は、例えば、クロム (C r) , インジウム (I n) , スズ (S n) , 亜鉛 (Z n) , カドミウム (C d) , チタン (T i) , アルミニウム (A l) , マグネシウム (M g) およびモリブデン (M o) からなる金属元素の群のうちの少なくとも 1 種を含む金属、導電性酸化物または金属化合物により構成されていることが好ましい。これらの物質は電気伝導度が高く、配線 1 2 B との電氣的な接合を良好に行うことができるからである。また、反射率の観点からは、可視光領域で吸収が少なく、反射補助膜として高い効果を得ることができるからである。また、密着層兼反射補助膜 1 4 D は、5 0 % 以上の反射率を有することが好ましい。より高い効果が得られるからである。本実施の形態では、密着層兼反射補助膜 1 4 D は、例えばクロム (反射率は 4 0 0 n m ないし 5 0 0 n m の波長範囲で約 7 0 % 前後、それ以上の波長になると緩やかに下がり、6 0 0 n m ないし 8 0 0 n m の波長範囲で約 6 6 % 前後) により構成されている。

【 0 0 6 6 】

密着層兼反射補助膜 14D の膜厚は、第 1 の実施の形態の密着層 14A と同様に、光を透過しない程度であることが好ましい。具体的には、密着層兼反射補助膜 14D をクロムにより構成する場合には、40 nm 以上 300 nm であることが好ましく、更に 50 nm 以上 150 nm であればより好ましい。

【0067】

反射層 14B は、例えば、第 1 の実施の形態と同様に、銀または銀を含む合金により構成されていることが好ましい。反射層 14B の膜厚は、例えば 10 nm 以上 150 nm 以下であることが好ましい。膜厚がこの範囲内であれば、密着層兼反射補助膜 14D との相乗効果により第 1 の実施の形態と同等の反射率が得られるからである。更に、10 nm 以上 100 nm 以下であればより好ましい。反射層 14B をより薄くすることにより表面粗さをより小さくすることができ、したがってバリア層 14C の膜厚をより薄くして光の取り出し効率を更に上げることができるからである。また、反射層 14B をより薄くすることにより、製造途中の熱工程により反射層 14B が結晶化して表面の凹凸が更に激しくなるのを緩和し、反射層 14 表面の凹凸によりバリア層 14C の欠陥が増加するのをより効果的に阻止することができるからである。

【0068】

バリア層 14C は、第 1 の実施の形態と同様に、例えば、透明無機材料により構成されていることが好ましく、具体的には、インジウム (In) とスズ (Sn) と酸素 (O) とを含む化合物 (ITO; Indium Tin Oxide), インジウム (In) と亜鉛 (Zn) と酸素 (O) とを含む化合物 (IZO; Indium Zinc Oxide), 酸化スズ (SnO₂), 酸化亜鉛 (ZnO), 酸化カドミウム (CdO), 酸化チタン (TiO₂) および酸化クロム (CrO₂) からなる群のうちの少なくとも 1 種により構成されることが好ましい。

【0069】

バリア層 14C の膜厚は、例えば、1 nm 以上 50 nm 以下であることが好ましく、更に、3 nm 以上 15 nm 以下であればより好ましい。本実施の形態では上述したように反射層 14B を薄くすることができるので、バリア層 14C の膜厚を上記範囲内まで薄くしても保護膜としての機能は確保されるからである。ま

た、バリア層 14C を薄くすることにより光の吸収損失を抑え、光の取り出し効率をより高めることができるからである。

【0070】

本実施の形態のように第 1 電極 14 を、密着層兼反射補助膜 14D、反射層 14B およびバリア層 14C を積層した構成とした場合には、上述したように反射層 14B の膜厚が第 1 の実施の形態よりも薄くすることができる。その場合、反射層 14B とバリア層 14C との界面で生じる反射光 h_2 は第 1 の実施の形態よりも小さくなり、密着層兼反射補助膜 14D と反射層 14B との界面で生じる反射光 h_1 は第 1 の実施の形態よりも大きくなる。よって、図 15 および図 16 に示したように、第 1 端部 P1 は、反射層 14B とバリア層 14C との界面および密着層兼反射補助膜 14D と反射層 14B との界面の両方と考えることができる。なお、バリア層 14C と有機層 16 との界面で生じる反射光 h_3 は、第 1 の実施の形態と同様にわずかであり、バリア層 14C は共振部に含まれる。

【0071】

この表示装置は、第 1 の実施の形態と同様に製造することができる。

【0072】

この表示装置では、例えば、第 1 電極 14 と第 2 電極 17 との間に所定の電圧が印加されると、有機層 16 の発光層 16B に電流が注入され、正孔と電子とが再結合することにより、主として発光層 16B の正孔輸送層 16A 側の界面において発光が起こる。この光は、第 1 端部 P1 と第 2 端部 P2 との間で多重反射し、第 2 電極 17 を透過して取り出される。本実施の形態では、第 1 電極 14 が密着層兼反射補助膜 14D、反射層 14B およびバリア層 14C を積層した構成とされているので、発光層 16B で発生しバリア層 14C および反射層 14B を透過した光は、密着層兼反射補助膜 14D で反射される。よって、反射層 14B の膜厚が薄くても高い反射率が維持される。

【0073】

このように、本実施の形態では、第 1 電極 14 を密着層兼反射補助膜 14D、反射層 14B およびバリア層 14C を積層した構成としたので、反射層 14B の膜厚を薄くしても密着層兼反射補助膜 14D により反射層 14B の反射率の低下

を補い、高反射率を得ることができる。更に、反射層 14 B の膜厚を薄くすることによりバリア層 14 C の膜厚も薄くすることができ、光の取り出し効率を高めることができる。

【0074】

【実施例】

更に、本発明の具体的な実施例について説明する。

【0075】

(実施例 1)

第 2 の実施の形態と同様にして、有機発光素子を作製した。その際、第 1 電極 14 を、膜厚 40 nm のクロムよりなる密着層兼反射補助膜 14 D と、膜厚 36 nm の銀を含む合金よりなる反射層 14 B と、膜厚 7.5 nm の ITO よりなるバリア層 14 C とを積層した構成とした。また、上述した共振器の共振波長（第 2 電極 17 側から取り出される光のスペクトルのピーク波長）は、400 nm および 800 nm とした。得られた有機発光素子について、第 1 電極 14 の反射率をそれぞれ調べた。得られた結果を図 17 に示す。

【0076】

本実施例に対する参照例 1～5 として、図 18 に示したように、反射層 114 B とバリア層 114 C のみからなり、密着層兼反射補助膜を省いたことを除き、本実施例と同様にして第 1 電極 114 を作製した。その際、反射層 114 B の膜厚は、参照例 1 では 36 nm、参照例 2 では 70 nm、参照例 3 では 90 nm、参照例 4 では 110 nm、参照例 5 では 150 nm とした。この参照例 1～5 についても、第 1 電極 114 の反射率を調べた。得られた結果を図 19 に示すと共に、参照例 1, 5 については図 17 にも合わせて示す。

【0077】

図 19 から分かるように、密着層兼反射補助膜を設けない参照例 1～5 では、反射層 114 B の膜厚が薄くなるに伴って、共振波長 800 nm および 400 nm のいずれの場合も反射率は低下した。中でも、反射層 114 B の膜厚を 100 nm 以下とした参照例 1～3 では、特に 400 nm の場合の反射率の低下が著しかった。これに対して、図 17 から分かるように、密着層兼反射補助膜 14 D を

設けた本実施例では、同じ膜厚の反射層 114B を有する参照例 1 に比べて、共振波長 800 nm および 400 nm のいずれの場合にも反射率が向上した。特に 400 nm の場合については、反射層 114B の膜厚を 150 nm と厚くした参照例 5 とほぼ同等の反射率を得ることができた。すなわち、第 1 電極 14 が密着層兼反射補助膜 14D を有するようにすれば、反射層 14B を薄くすることによる反射率の低下を補うことができ、特性を改善できることが分かった。

【0078】

(実施例 2)

密着層 14A の膜厚を 150 nm としたことを除き、他は実施例 1 と同様にして第 1 電極 14 を作製し、反射率を調べたところ、実施例 1 と同様の結果が得られた。得られた結果を図 17 に合わせて示す。

【0079】

以上、実施の形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態および実施例に限定されるものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記実施の形態および実施例において説明した各層の材料および膜厚、または成膜方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および膜厚としてもよく、または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。例えば、密着層 14A または密着層兼反射補助膜 14D は、スパッタ法のほか、蒸着法、CVD 法、MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition ; 有機金属気相成長) 法、レーザーアブレーション法、あるいはメッキ法などを用いることが可能である。反射層 14B についても、同様に、スパッタ法のほか、蒸着法、CVD 法、MOCVD 法、レーザーアブレーション法、あるいはメッキ法などを用いることが可能である。

【0080】

また、例えば、上記実施の形態および実施例においては、密着層 14A または密着層兼反射補助膜 14D、反射層 14B およびバリア層 14C をウェットエッチングによりパターニングするようにした場合について説明したが、ドライエッチングによりパターニングしてもよい。

【0081】

更に、例えば、上記実施の形態および実施例においては、バリア層 14 C と反射層 14 B とをパターンニングしたのち、密着層 14 A または密着層兼反射補助膜 14 D をパターンニングするようにした場合について説明したが、まず図 20 (A) に示したように、バリア層 14 C のみをパターンニングし、そののち図 20 (B) に示したように、反射層 14 B と密着層 14 A または密着層兼反射補助膜 14 D とをパターンニングするようにしてもよい。また、バリア層 14 C、反射層 14 B および密着層 14 A または密着層兼反射補助膜 14 D をバリア層 14 C 側から一層ずつパターンニングするようにしてもよい。

【0082】

加えて、例えば、上記第 2 の実施の形態においては、密着層と反射補助膜とを兼ねる密着層兼反射補助膜 14 D を備えた場合について説明したが、下地層としての平坦化層 13 側から反射補助膜と密着層とをこの順に積層した積層構造としてもよい。

【0083】

更にまた、上記実施の形態では、有機発光素子 10 R, 10 G, 10 B の構成を具体的に挙げて説明したが、絶縁膜 15, 補助電極 17 A あるいは保護膜 18 などの全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい。なお、第 2 電極 17 A を半透過性電極でなく透明電極とし、共振器構造を備えない場合についても本発明を適用することができるが、本発明は、第 1 電極 14 での反射率を高めるものであるので、第 1 電極 14 の発光層 16 B 側の界面を第 1 端部 P 1、第 2 電極 17 の発光層 16 B 側の界面を第 2 端部 P 2 とし、有機層 16 を共振部として共振器構造を構成する場合の方が、より高い効果を得ることができる。

【0084】

加えてまた、上記実施の形態では、本発明を有機発光素子あるいは有機発光素子を備えた表示装置に適用した場合について説明したが、本発明は、例えば液晶表示パネルなどの他の表示装置にも適用可能である。

【0085】

【発明の効果】

以上説明したように本発明の発光素子または本発明の表示装置によれば、第1電極を密着層、反射層およびバリア層を積層した構成としたので、反射層の剥離あるいは変質を防止することができ、ひいては反射層の変質に起因する第1電極と第2電極との短絡の発生などを防止することができる。よって、反射層を銀（Ag）または銀を含む合金により構成する場合に特に好適であり、表示装置の欠陥を低減し、寿命を長くすることができる。

【0086】

本発明の発光素子の製造方法によれば、下地層の上に、密着層、反射層およびバリア層をすべて形成したのちに、バリア層側から順にパターンニングすることにより第1電極を形成するようにしたので、バリア層により、反射層を構成する材料が空気中の酸素または硫黄成分と反応することを防止することができると共に、反射層を形成した後の製造工程においても反射層に対するダメージを緩和することができる。また、密着層により、反射層が下地層から剥離するのを防止することができ、剥離した部分に侵入した空気あるいは薬液などによる反射層への悪影響を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態に係る表示装置の構成を表す断面図である。

【図2】

図1に示した有機発光素子の構成を拡大して表す断面図である。

【図3】

図1に示した有機発光素子の構成を拡大して表す断面図である。

【図4】

図1に示した表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。

【図5】

図4に続く工程を表す断面図である。

【図6】

図5に続く工程を表す断面図である。

【図7】

図 6 に続く工程を表す断面図である。

【図 8】

図 7 に続く工程を表す断面図である。

【図 9】

図 8 に続く工程を表す断面図である。

【図 10】

図 9 に続く工程を表す断面図である。

【図 11】

図 10 に続く工程を表す断面図である。

【図 12】

図 11 に続く工程を表す断面図である。

【図 13】

図 12 に続く工程を表す断面図である。

【図 14】

本発明の第 2 の実施の形態に係る表示装置の構成を表す断面図である。

【図 15】

図 14 に示した有機発光素子の構成を拡大して表す断面図である。

【図 16】

図 14 に示した有機発光素子の構成を拡大して表す断面図である。

【図 17】

本発明の実施例に係る有機発光素子の第 1 電極の反射率を表す図である。

【図 18】

本発明の参照例に係る有機発光素子の第 1 電極の構成を表す断面図である。

【図 19】

図 18 に示した参照例に係る第 1 電極の反射率を表す図である。

【図 20】

図 6 に示した工程の変形例を工程順に表す断面図である。

【符号の説明】

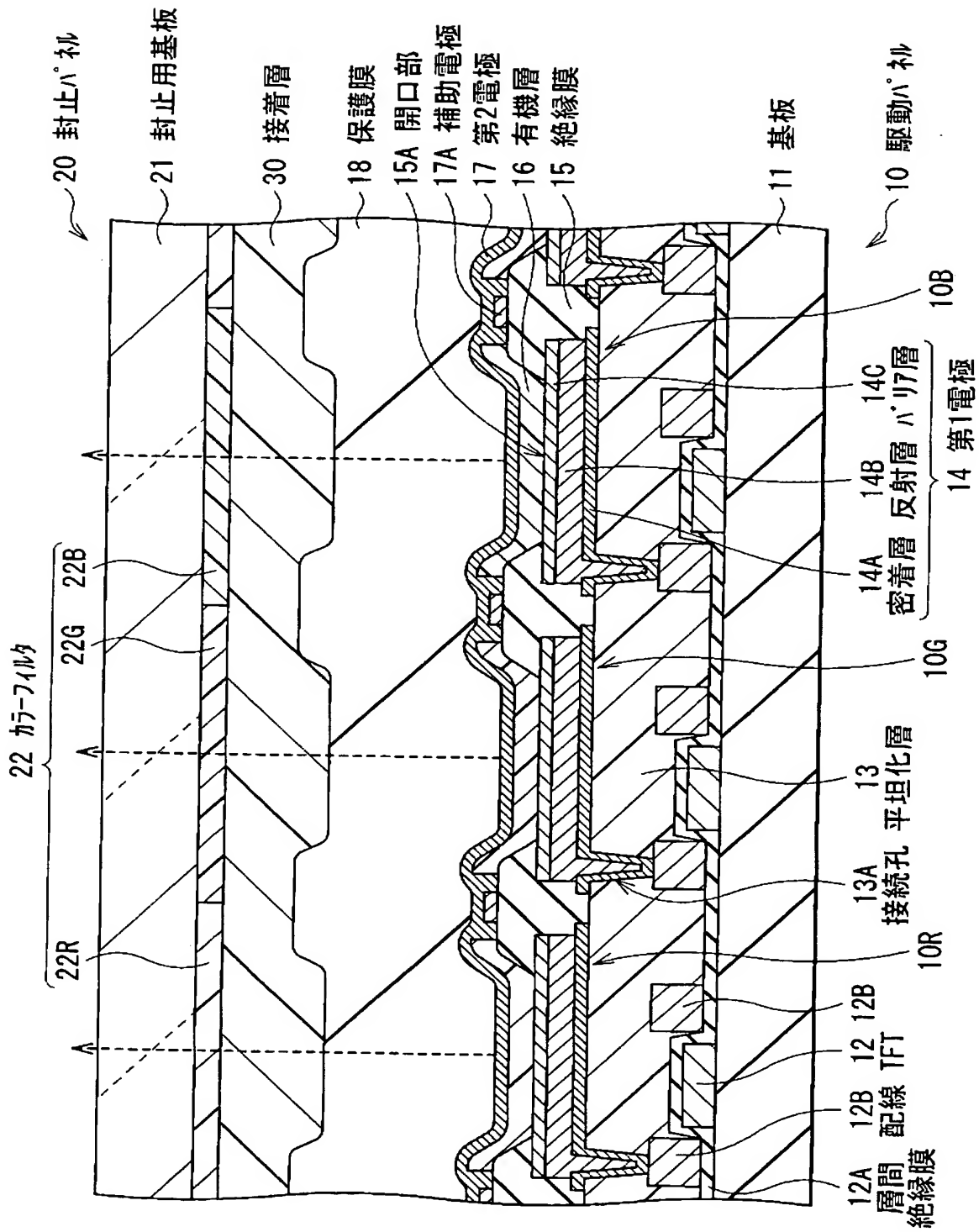
10…駆動パネル、10R、10G、10B…有機発光素子、11…基板、1

2…T F T、1 2 A…層間絶縁膜、1 2 B…配線、1 3…平坦化層、1 3 A…接続孔、1 4…第 1 電極（陽極）、1 4 A…密着層、1 4 B…反射層、1 4 C…バリア層、1 4 D…密着層兼反射補助膜、1 5…絶縁膜、1 5 A…開口部、1 6…有機層、1 6 A…正孔輸送層、1 6 B…発光層、1 6 C…電子輸送層、1 7…第 2 電極（陰極）、1 7 A…補助電極、2 0…封止パネル、2 1…封止用基板、2 2…カラーフィルタ、2 2 R…赤色フィルタ、2 2 G…緑色フィルタ、2 2 B…青色フィルタ、3 0…接着層、4 1…マスク、4 1 A…開口

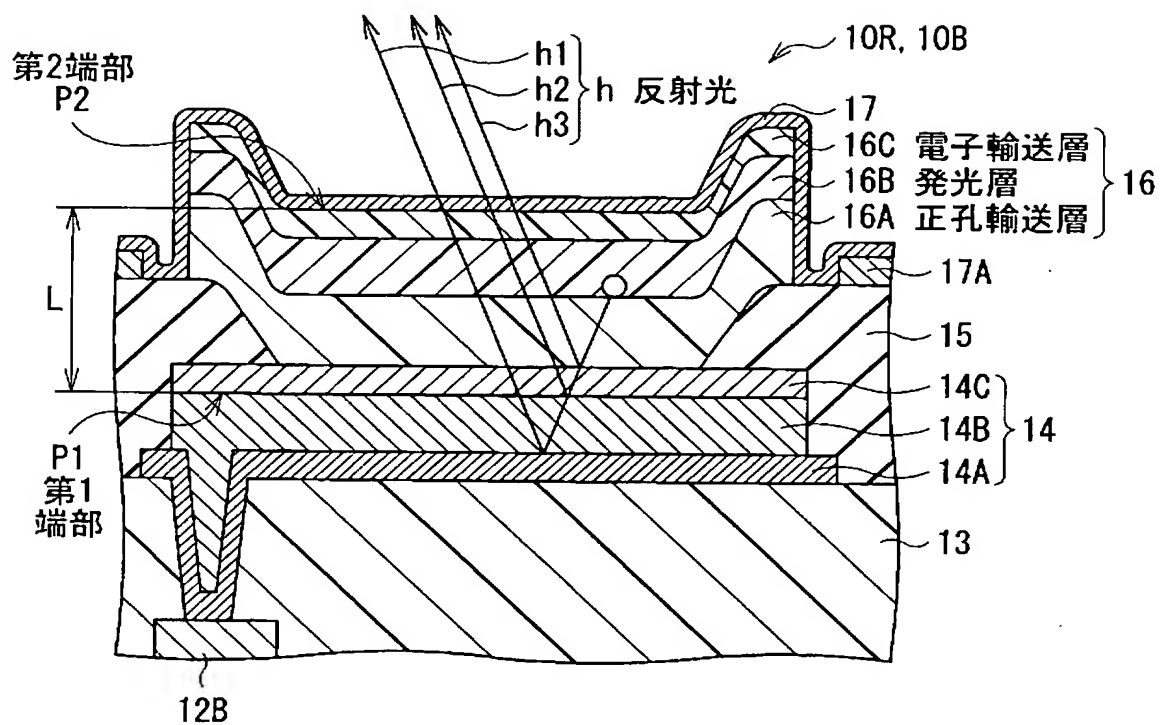
【書類名】

図面

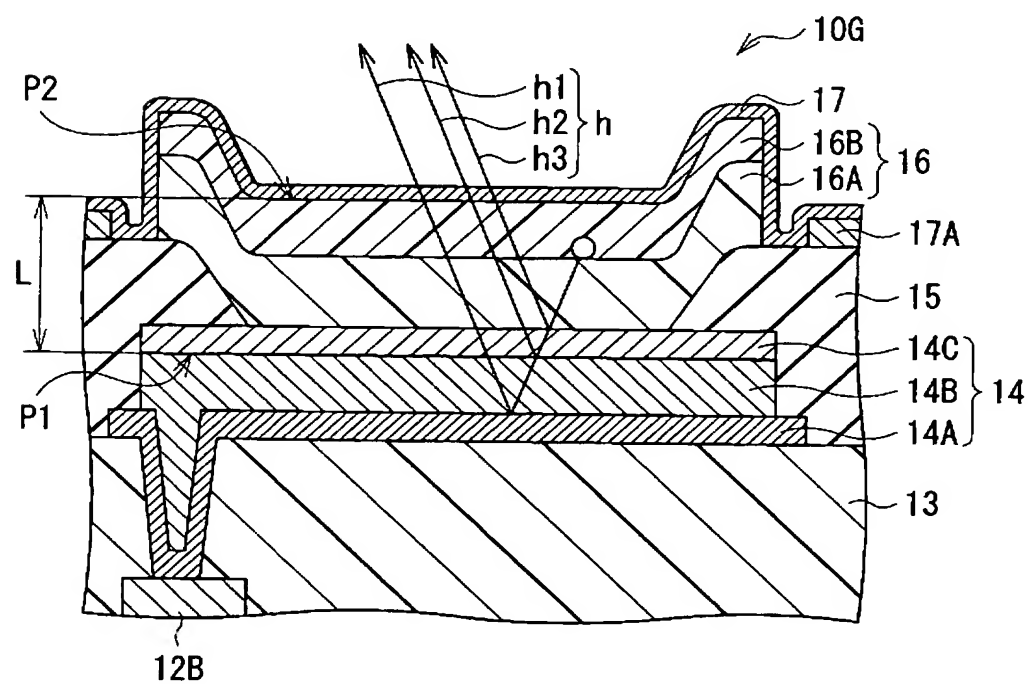
【図1】



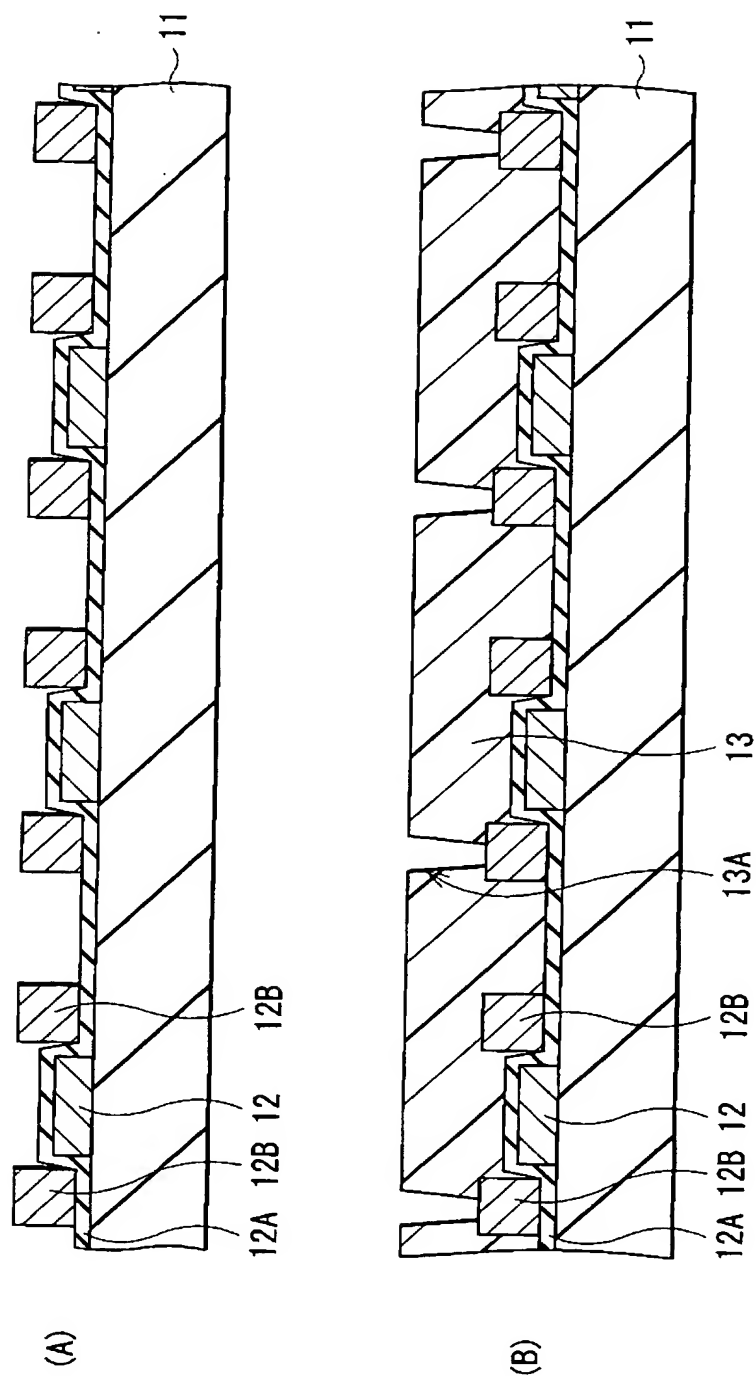
【図 2】



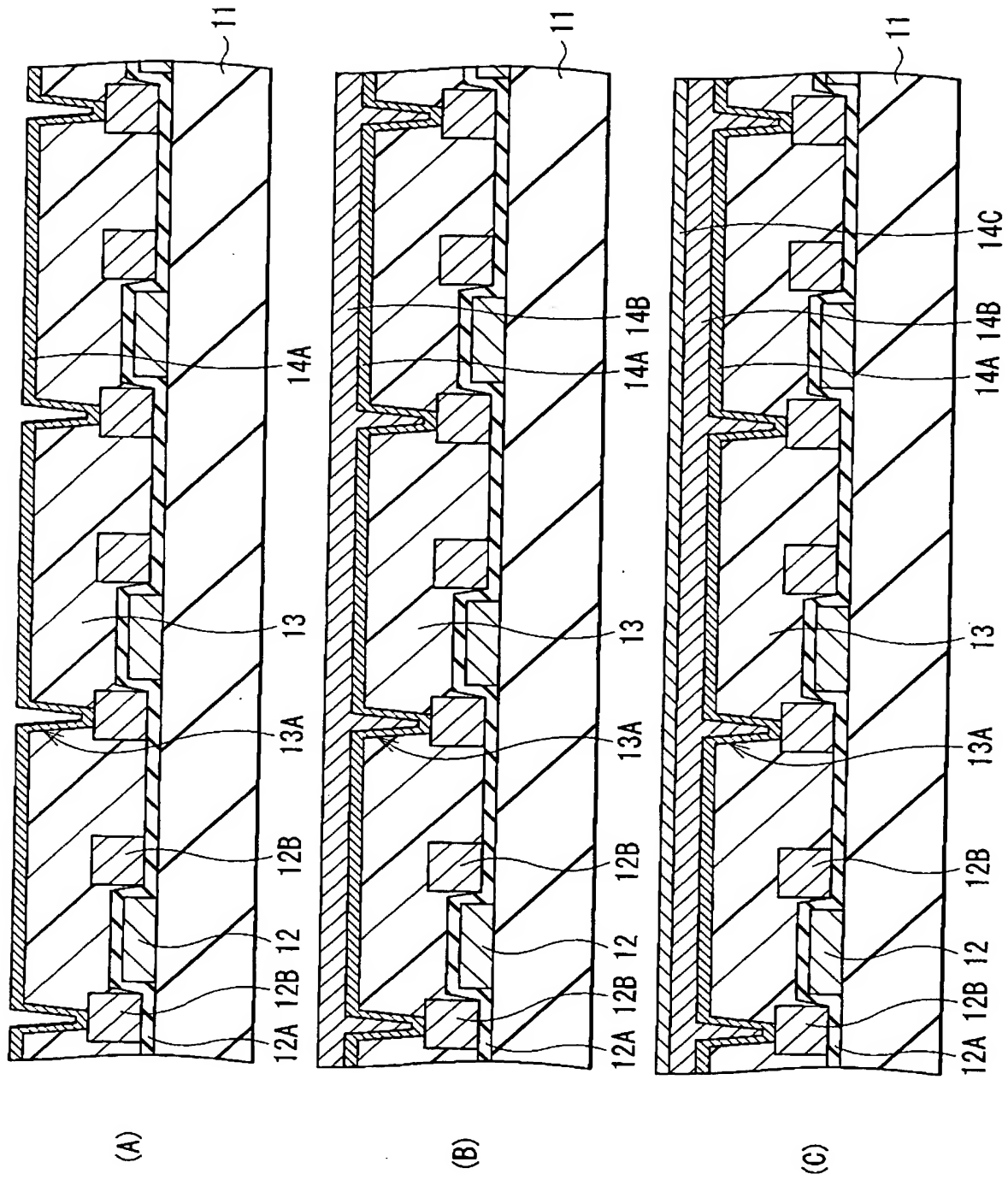
【図 3】



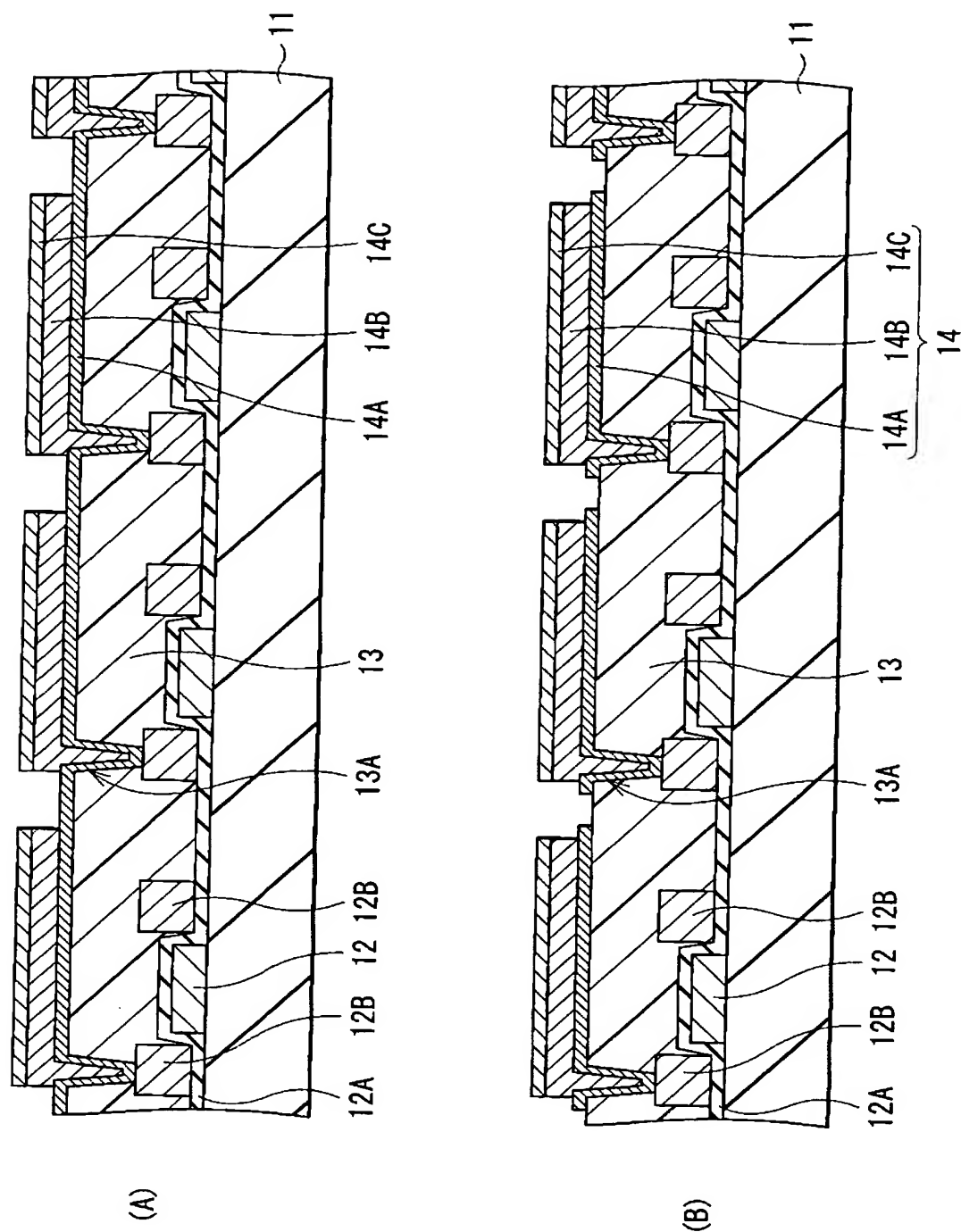
【図 4】



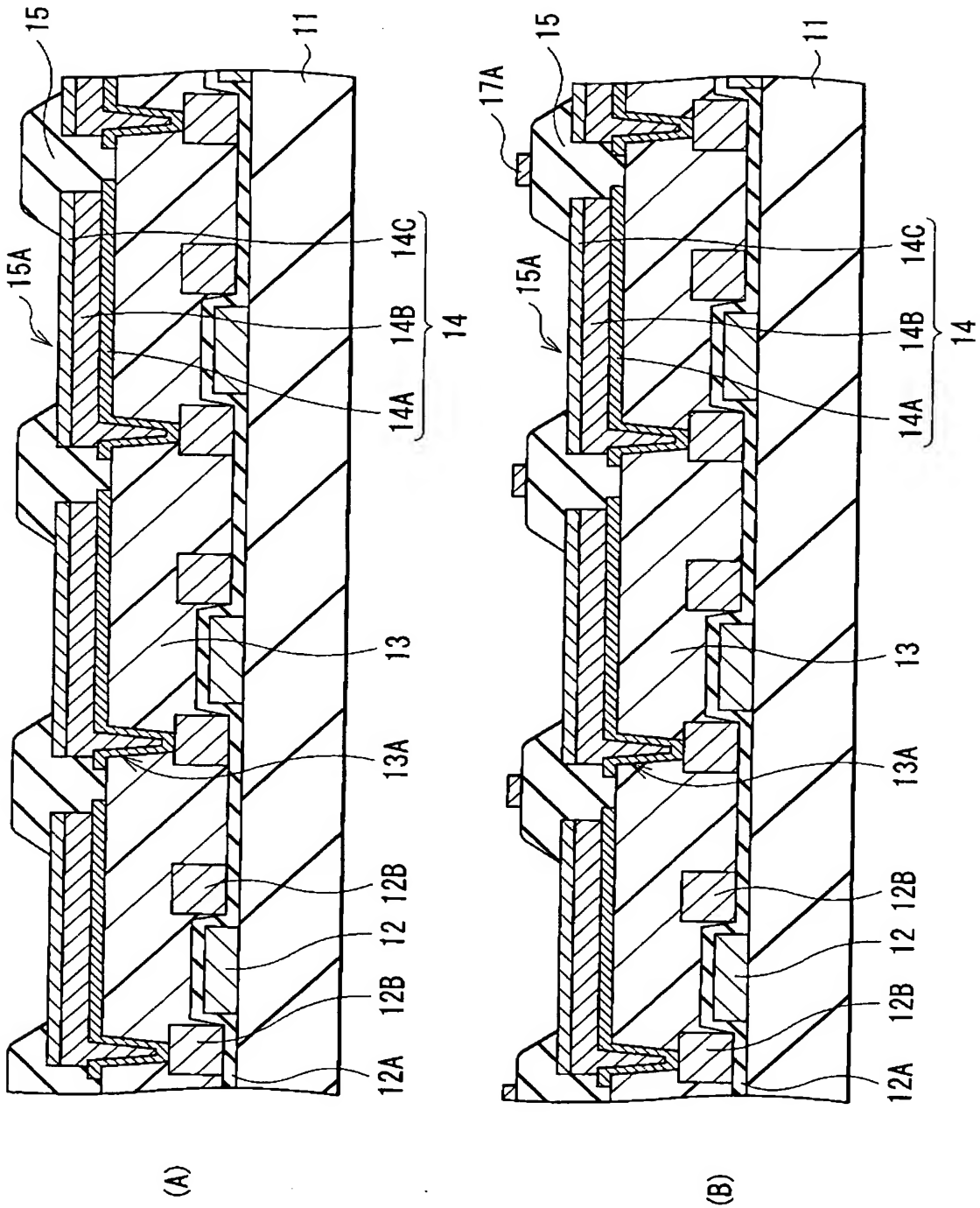
【図 5】



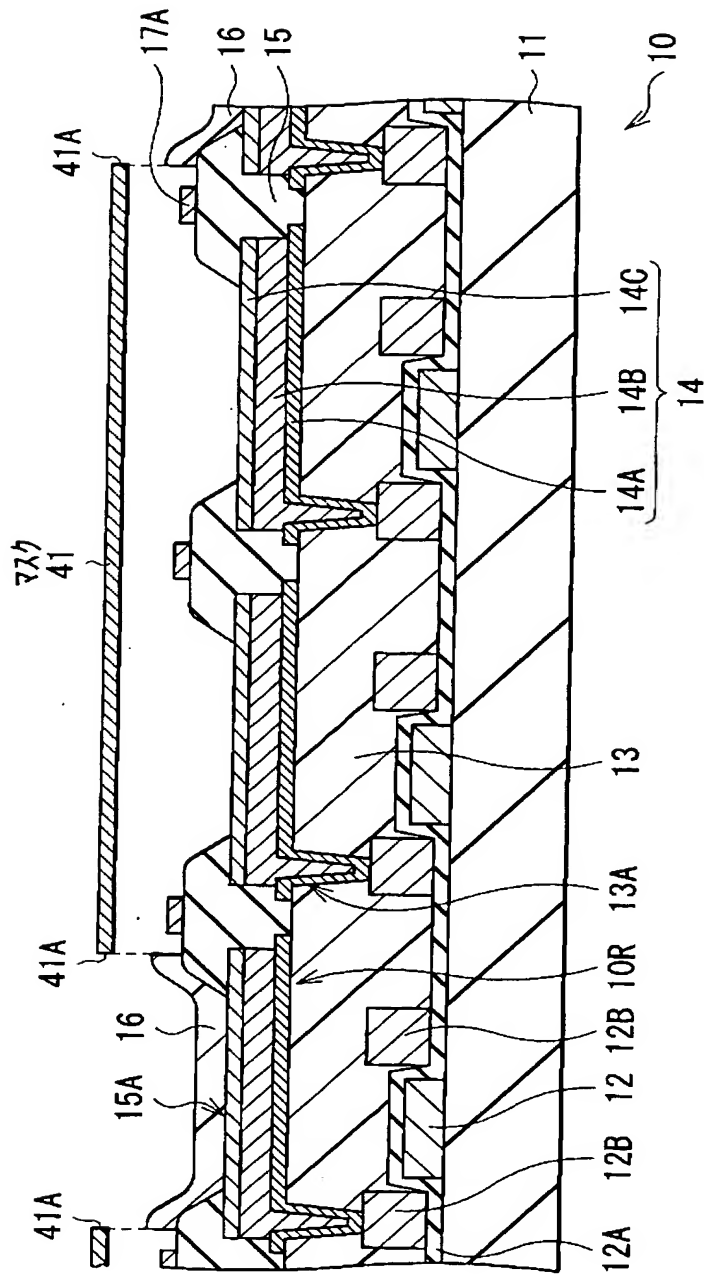
【図 6】



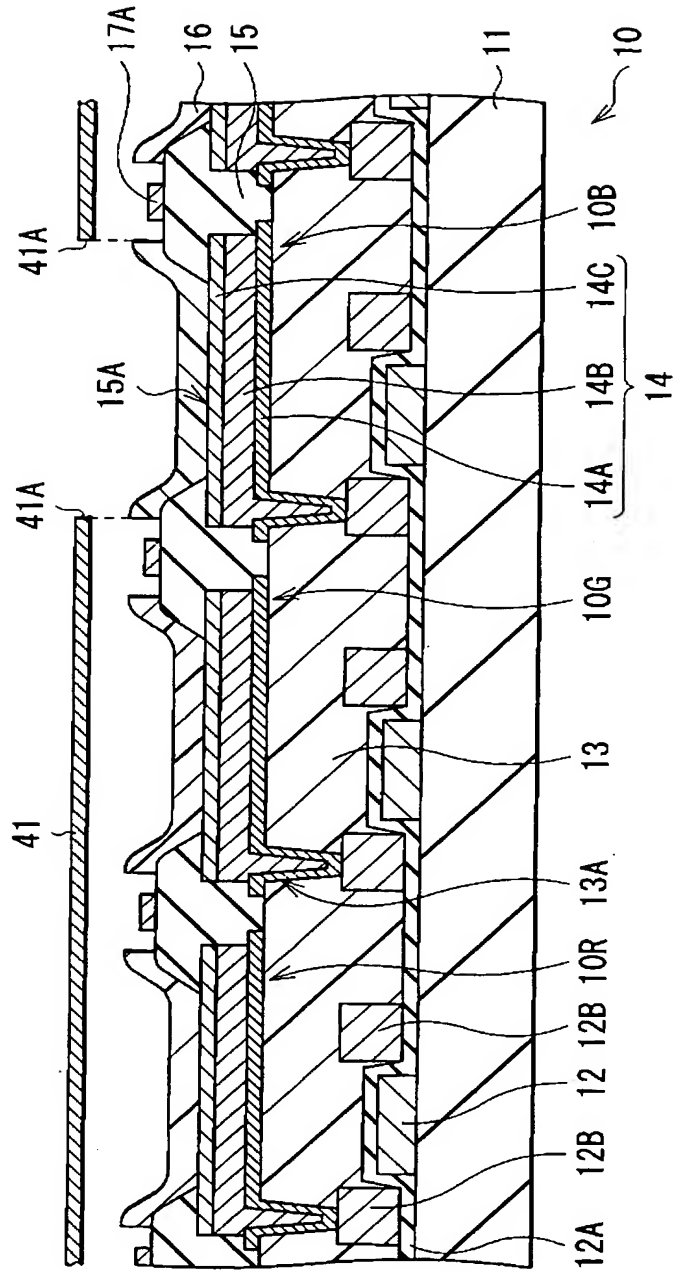
【図 7】



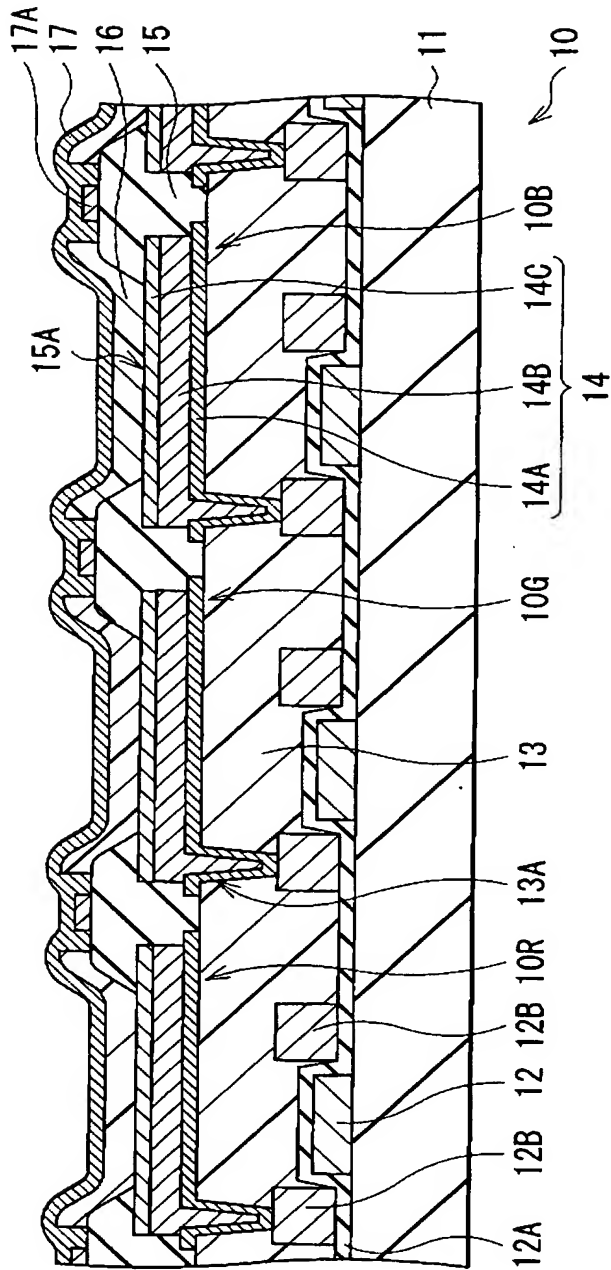
【図 8】



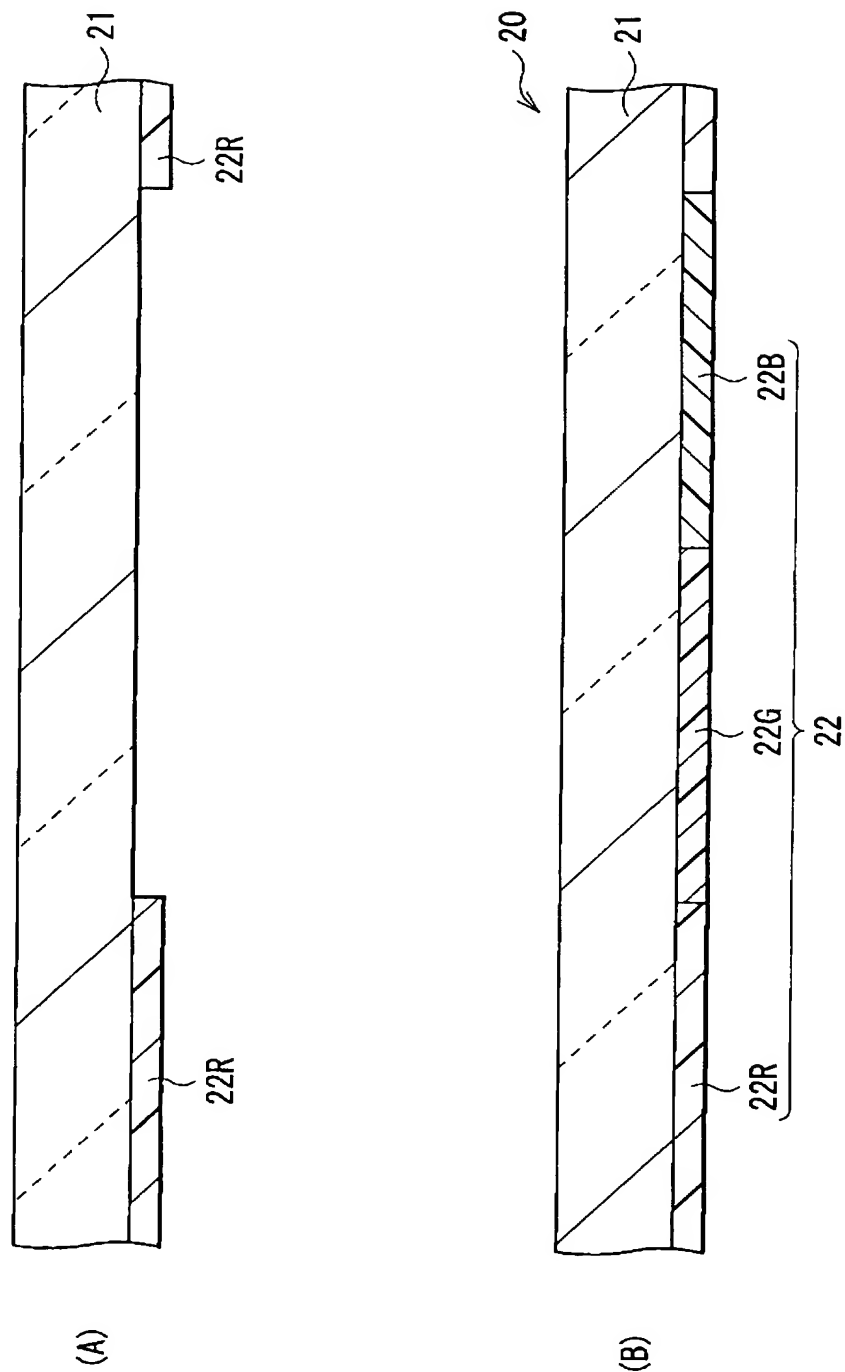
【図 9】



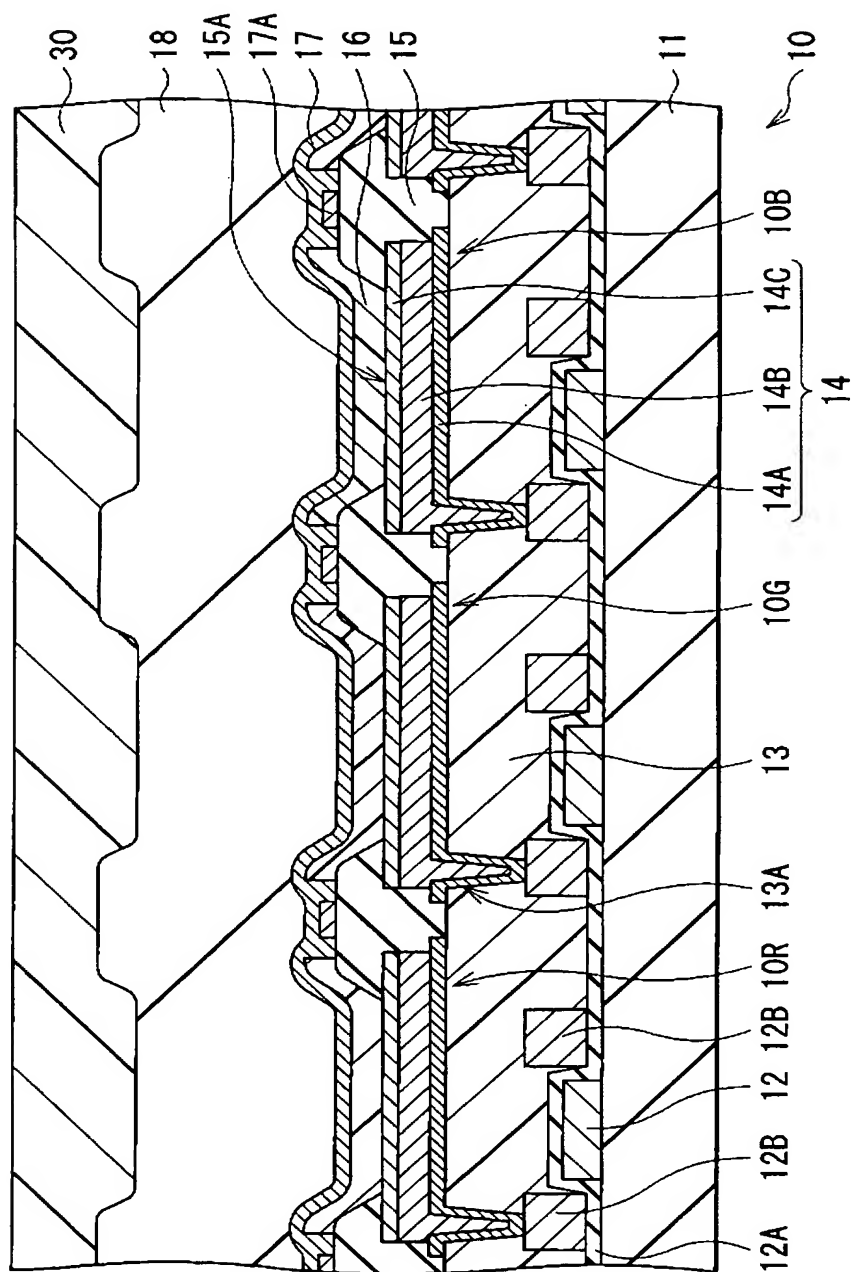
【図 10】



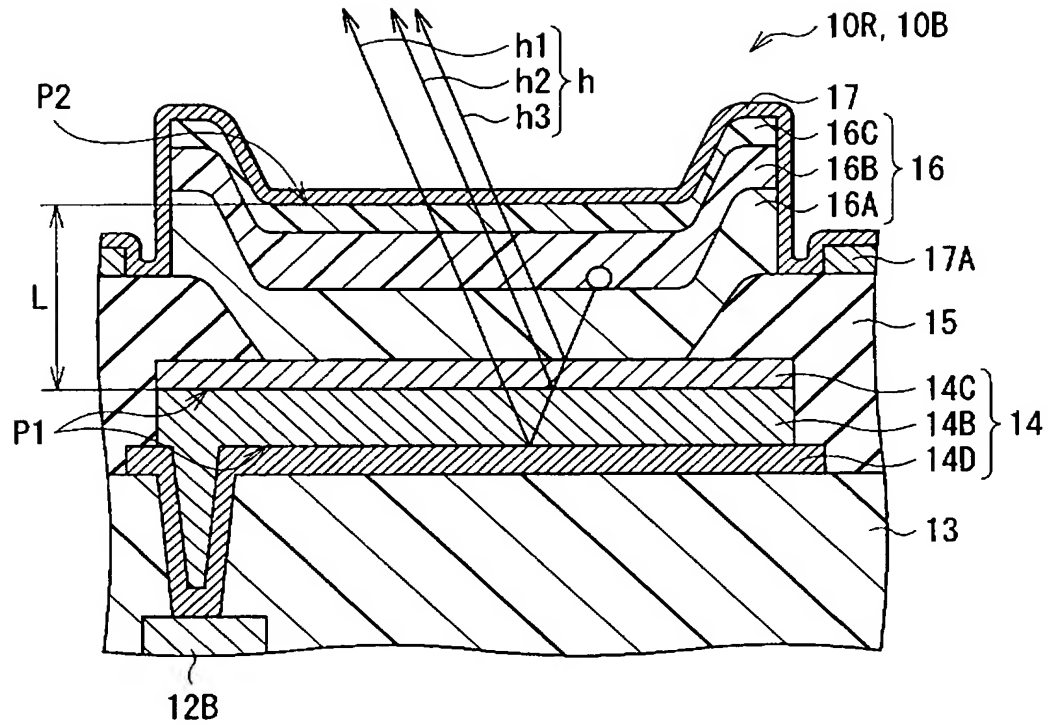
【図 12】



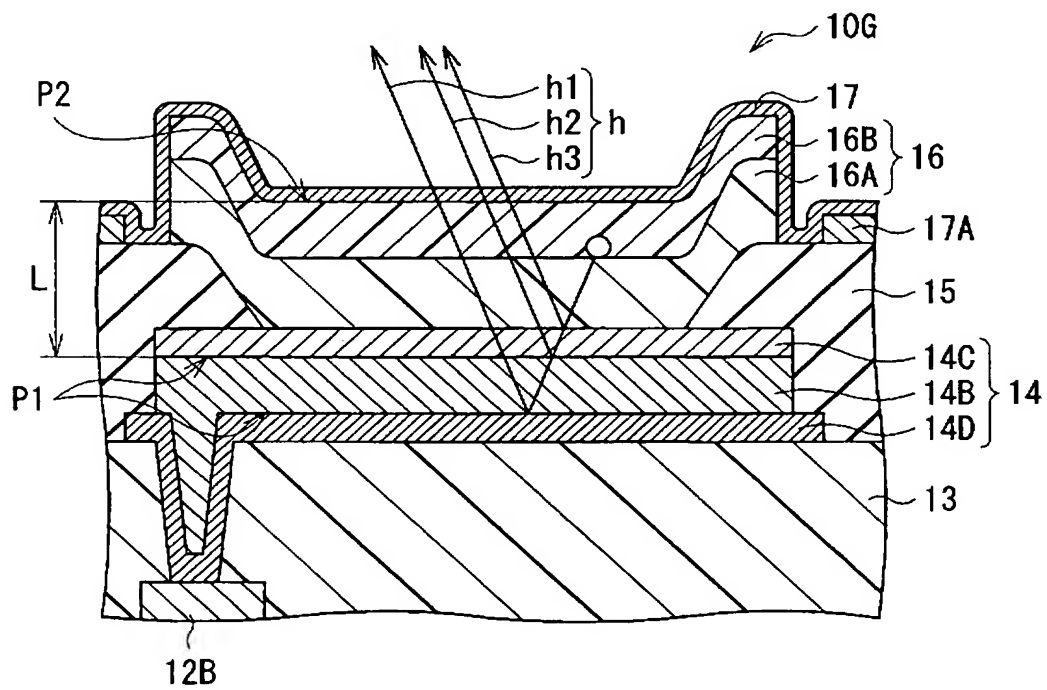
【図 13】



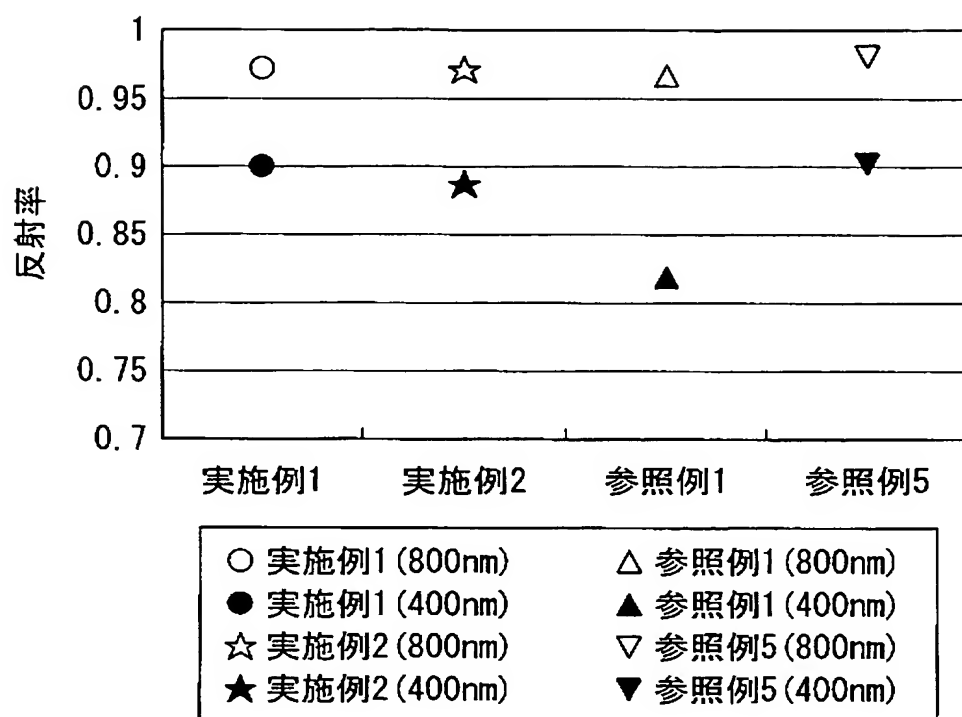
【図 15】



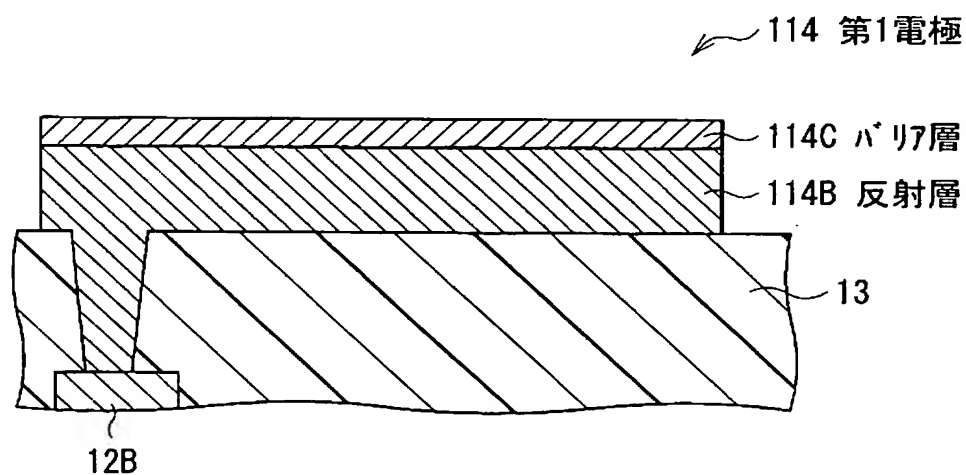
【图 16】



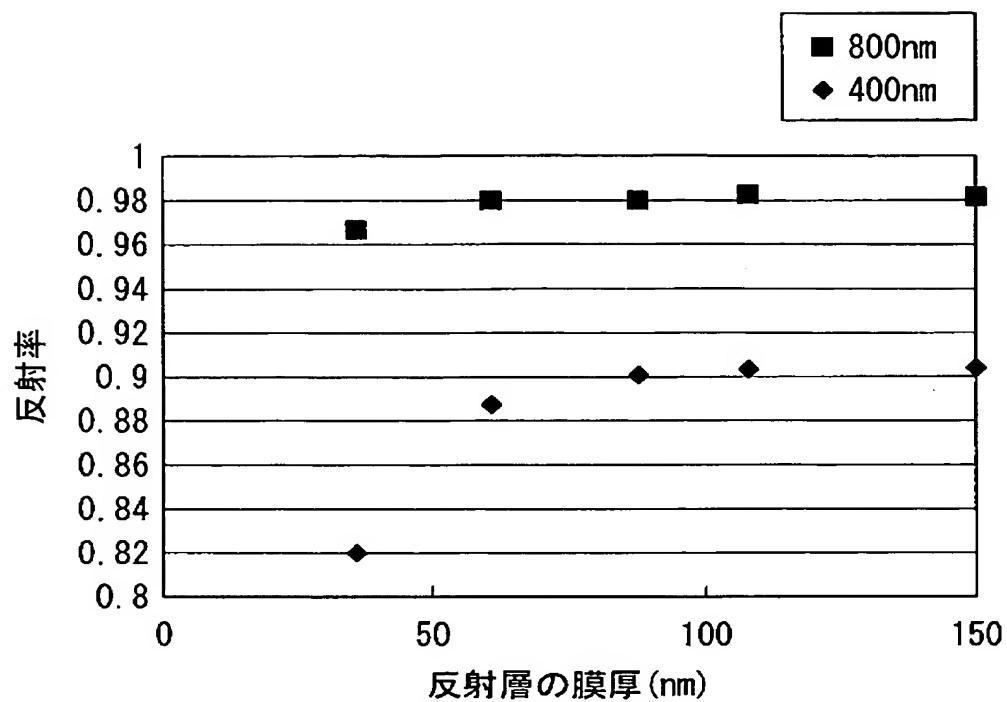
【図 17】



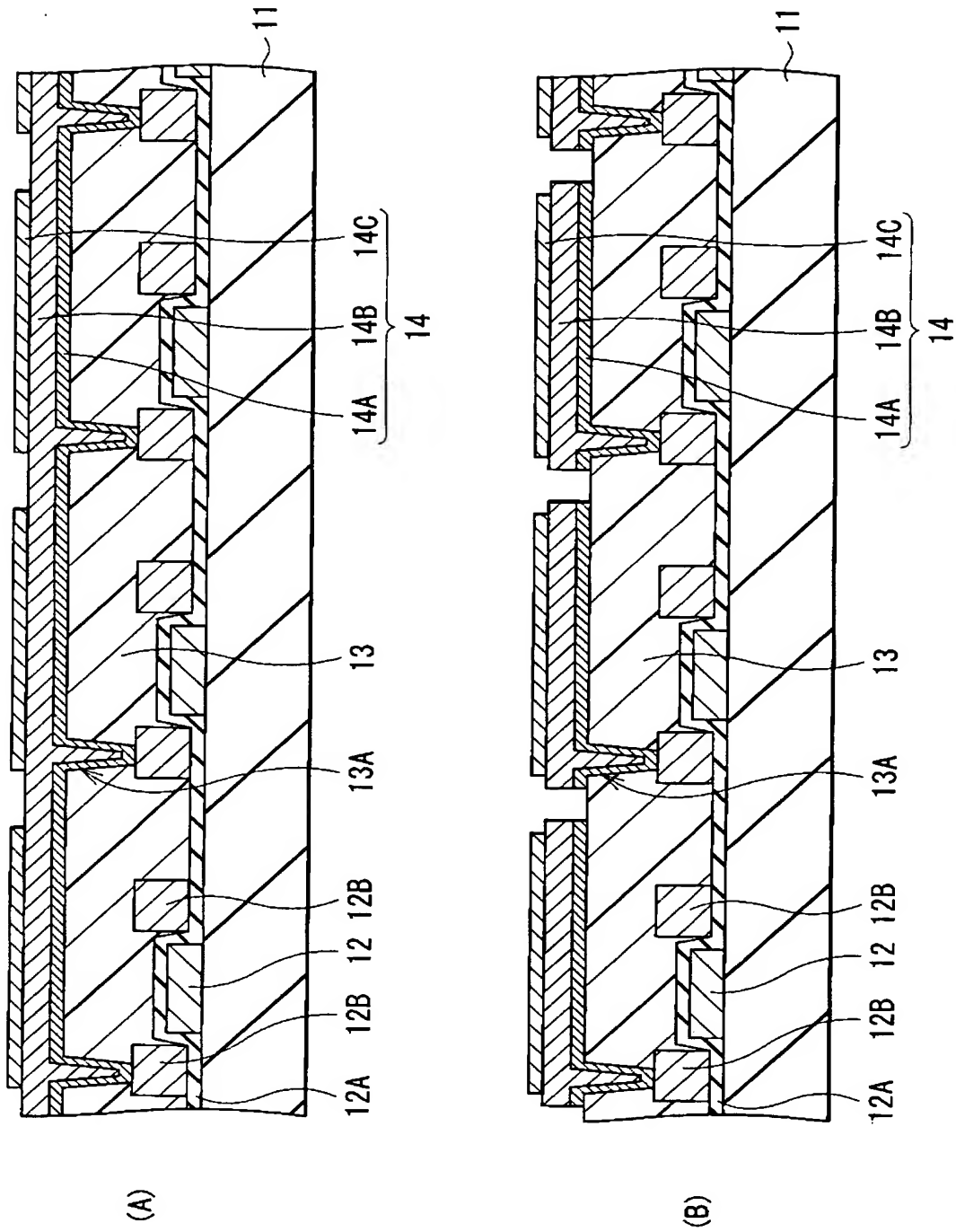
【図 18】



【図 19】



【図 20】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 第 1 電極の剥離あるいは変質を防止して高性能を得ることができる発光素子およびその製造方法、ならびに表示装置を提供する。

【解決手段】 基板 1 1 の側から、下地層である平坦化層 1 3 を介して、陽極としての第 1 電極 1 4、絶縁膜 1 5、発光層を含む有機層 1 6、および陰極としての第 2 電極 1 7 がこの順に積層されている。第 1 電極 1 4 は、基板 1 1 の側から、密着層 1 4 A、反射層 1 4 B およびバリア層 1 4 C がこの順に積層された構成を有している。バリア層 1 4 C により反射層 1 4 B の変質が防止されると共に、密着層 1 4 A により、反射層 1 4 B が平坦化層 1 3 から剥離することが抑制される。第 1 電極 1 4 は、平坦化層 1 3 の上に、密着層 1 4 A、反射層 1 4 B およびバリア層 1 4 C をすべて形成したのちに、バリア層 1 4 C 側から順にパターニングすることにより形成される。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 1 5 3 0 5 3
受付番号	5 0 3 0 0 8 9 6 4 9 3
書類名	特許願
担当官	第四担当上席 0 0 9 3
作成日	平成 1 5 年 6 月 3 日

< 認定情報・付加情報 >

【特許出願人】

【識別番号】	000002185
【住所又は居所】	東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号
【氏名又は名称】	ソニー株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100098785
【住所又は居所】	東京都新宿区新宿 1 丁目 9 番 5 号 大台ビル 2 階 翼国際特許事務所
【氏名又は名称】	藤島 洋一郎

次頁無

特願 2 0 0 3 - 1 5 3 0 5 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 2 1 8 5]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 3 0 日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号
氏 名	ソニー株式会社